物性研だより



1 States	
1	第一原理分子動力学法による電極表面
	シミュレーション・・・・・・・・・・・・・・・・・森川良忠
8 4	メゾスコピック系の伝導現象の研究・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 中西 駿
6	重い電子系の研究と冷凍機・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・稲田佳彦
欠 9	外国人客員所員を経験して
	Makariy TANATAR
	Rashid GANEEV
	Woun KANG
	研究室だより
13	○柴山研究室・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 柴山充弘
22	物性研究所短期研究会報告
	○個体における水素の科学
52	物性研究所談話会
	物性研ニュース
54	〇人事異動
55	○物性研だより第45巻目録(第1号~第4号)
	編集後記
	HL MAR
	分子分散 相格
	温度敏感型プロック共産 合体水浴液の構造転移。 ジブロックコポリマー
	わずか数度の間に、分子 る。

藤水雪相互作用により.

感動応答性部位が凝集

してコアとなり、ミクロ相分離が起こる。

Sol

領域を経て超格子構造領

城へと温度可逆的に転移

する。その間、溶液の粘

度は十万倍ほども変化し、 さらさらの液体からゲル

化、非流動化する。



東京大学物性研究所

ミセル構造

155N 0385-9843

柚子状にパッキング

Gel

する.

第一原理分子動力学法による電極表面シミュレーション

大阪大学産業科学研究所、物性研究所客員助教授 森川 良忠

近年、有機電界発光素子(有機 EL)、有機太陽電池、有機電界効果トランジスタ等、有機分子薄膜を電子デバイスに 応用する研究が盛んになされている。さらに、その先の技術として、一つの分子を電子素子として利用することを目指し た基礎研究も注目を集めている。これらの電子デバイスの効率は、有機分子と金属電極との界面での構造や電子状態に大 きく左右される。特に、有機分子の HOMO(最高被占軌道)、LUMO(最低空軌道)といった分子軌道と電極金属のフ ェルミレベルとのエネルギー準位関係が、金属から有機分子層への電荷注入障壁を支配する。最も単純には、図 1(a)に示 すように、金属電極から有機分子層への電子注入障壁は、金属の仕事関数と分子層の電子親和力の差になり、正孔注入障 壁は金属の仕事関数と分子層のイオン化エネルギーとの差

$\boldsymbol{\Phi}_{\mathrm{B}}^{\mathrm{n}} = \boldsymbol{\Phi}_{m} - \boldsymbol{A},$	(1)
$\Phi_{\rm B}^{\rm p} = I - \Phi_{\rm m}$,	(2)

になると考えられる。しかしながら、実際には図1(b)に示す ように、多くの金属と有機分子との界面では界面電気二重層 が生じ、金属電極と分子層とのポテンシャルにはずれ(Δ)が 生じることが実験的に指摘されている[1,2]。この界面電気二 重層によるポテンシャルのずれは1eV程度になり、有機分子 層のHOMO-LUMOギャップが数eVであることを考えると、 Δ は電荷注入障壁に大きな影響を与えることがわかる。



$\Phi_{\rm B}^{\rm n} = \Phi_{\rm m} - A + \Delta,$	(3)
$\boldsymbol{\Phi}_{\mathrm{B}}^{\mathrm{p}} = I - \boldsymbol{\Phi}_{m} - \boldsymbol{\Delta},$	(4)

図1. 有機 - 金属界面での電子状態。(a)が従来モデル、(b)が界面 電気二重層を考慮したモデル。

様々な有機分子と金属表面との組み合わせについて研究がなされ、次の二つの傾向があることが示された。1)多くの有 機-金属界面では Δ は負となるように界面電気二重層が生じる。2)基板金属の仕事関数 (\varPhi/m)が大きいほど Δ の大きさ も大きくなる。界面電気二重層が生成する原因としては、有機分子-金属表面間での電子移動や、化学結合を作ることに よって電子配置が変化すること、あるいは、有機分子自身が持つ双極子が並ぶこと、有機分子層のギャップ内に界面状態 が生じ、それがキャリヤーのバッファーとなることによってポテンシャルが変化するなどが提案されている。しかしなが ら、なぜ、多くの有機-金属界面で Δ が負になるか、また、なぜ \varPhim と Δ の大きさに相関があるか、確かな説明はなされ ていない。界面電気二重層の生成要因を明らかにし、さらにはそれらを制御していくことは、有機分子デバイスの性能を 向上させるためには必要不可欠のことと考えられる。われわれのグループでは第一原理電子状態計算によってこれらの疑 問を解き明かす研究を進めている[3-5]。

n-アルカンは電気双極子モーメントは持たず、また、金属表面とも化学的な結合を作らない

ので、界面電気二重層が形成することは考えにくいが、n-アルカンがほぼ一層吸着することによって、銅表面で約-0.3eV、 銀表面では約-0.5eV、金表面では-0.7eVもの Δ が観測されている。このような物理吸着系で界面電気二重層が生成す る原因としては、1)金属表面付近では鏡像ポテンシャルによって電子が表面側により強く引きつけられるため分子が分 極する効果、2)金属表面では電子が真空側に染み出しているが、それが分子の吸着によって表面側に押し戻されること によって電子分布が変化する効果 (push back 効果)が提案されている。これらの効果ではいずれも負の Δ を与える電気 二重層が生成する。 図2にn-アルカン分子がC-C-C面を基板に平行して吸着した図を示す。そして、図3 に様々な基板金属表面上での $\Delta \varepsilon Z_c$ の関数として示す。この図で重要なことは、各表面で の曲線は互いに良く似ており、また、必ずしも基板の仕事関数の順に並んでいるものではな いということである。つまり、アルカン分子の吸着位置が各基板でほぼ同じと仮定すると、 基板金属の仕事関数が大きいほど界面電気二重層も大きくなるという傾向は再現しない。こ れは、仕事関数の大きい基板金属ほど分子による染み出した電子の押し戻し効果が大きくな っているという直感的な描像は成り立っていないことを示している。そうでは無くて、より 大きな $\Delta \varepsilon$ 持つ基板上では分子ー表面間の距離はより近づいていることを強く示唆してい る。すなわち、基板金属の仕事関数と、分子吸着によるポテンシャルの変化(Δ) は直接的 な相関はなく、基板金属の仕事関数が大きい程、分子ー基板間の距離が小さくなる傾向があ るために、 Δ も大きくなると考えられる。



第4図には各基板の仕事関数とZcoptの関係を図示してある。基板の仕事関数が大きいほ

図2. n-アルカンが金属表面 上に吸着した構造

ど Zcopt が小さくなるという傾向があることを概ね示している。仕 事関数の大きな金属は Pt や Au など 5d 電子を持つ金属であるが、 5d 電子は 3d や 4d 軌道に比較して広がっており、そのために分極し やすく、ファンデルワールス相互作用に対する寄与が大きくなり、 分子をより表面に近づけるのではないかと考えられる。このように、 基板金属の仕事関数と界面電気二重層の大きさが直接関係を持つの ではなく、仕事関数の大きい金属表面上では分子-金属間距離が小 さくなる傾向があるため、その結果として界面電気二重層も大きく なっているということがわかった。

tris-(8-hydroxy quinolinato) aluminum (Alq₃) という分子は有機 EL デバイスの電子輸送層およびエミッション層の材料として最も 良く使われている分子である。金属電極から電子輸送層への電子注 入効率が有機 EL デバイスの効率を大きく左右することから、Alq3 分子と金属との界面に関する研究は多くなされてきた。実験的 には界面で分子のギャップ内に新たな状態が観測され、また、 -1.4eV もの界面電気二重層が観測され、基板-分子間に強い化学 的相互作用があると考えられている。図5にAlq3がAl表面に吸着 した構造のシミュレーション結果を示す。この図が示しているよう に、Alq、分子の酸素原子と基板の Al とが結合を作っていることが 重要であることがわかる。この点は、様々な分子の配置を計算して 調べたところ、基板との結合エネルギーは酸素原子が基板 Al 原子と 作る結合の数に依存することからも確かめられる。また、多くの酸 素原子が基板と結合を作って安定になる構造は、ちょうど分 子の持つ双極子が真空側を向き、表面の仕事関数を 1.0eV~ 1.6eV 下げる。これは実験値の-1.4eV と良く一致しており、 界面の電気双極子は主として分子の持つ永久双極子によるも のであることが明らかとなった。さらに、界面での分子の HOMO レベル、LUMO レベルと基板のフェルミレベルとの 位置関係は、分子の持つ双極子の方向によって大きく変わる こともわかった。このため、実験的に観測された界面ギャッ プ状態は、いくつかの異なる分子の配向によって双極子の方



図3.様々な金属表面でのn-アルカン吸着による仕事関数変化。



図4. 金属表面の仕事関数と金属-分子間距離の相関



図5. Al 表面上でのAlq3分子の吸着構造

向が異なり、HOMO レベルが異なる準位となって見えることに由来すると考えられる。

有機/金属界面のシミュレーションに加えて、我々のグループが力を入れて研究を進めているのが、水と金属電極との界 面での反応シミュレーションである。最近、効率的なエネルギー変換機器として燃料電池が注目されているが、それに伴 い、水と金属との界面での反応シミュレーションの重要性も増している。しかしながら、その複雑さのために、金属表面 との界面の構造のシミュレーションはあまり行われていない。特に、溶媒である水の影響は大きく、また、電極界面での 電場の影響も取り入れる必要があり、両者の効果を適切に取り入れたシミュレーションはまだ行われていない。その予備 的な研究として、Pt や Rh 金属表面上の氷の吸着状態について研究を進めている(図 6)。第一原理分子動力学シミュレ ーションにより安定構造や振動モード、振動スペクトルを求め、東大物性研吉信グループの実験と比較することにより水 と金属との界面構造を明らかにすることを目指している。さらに、図7に示すように、溶媒としての水の影響と、電極表 面での電場の影響の両方を取り入れて、現実に出来る限り近いモデルを用いて電極反応をシミュレーションすることを目 指している。この研究は濱田幾太郎氏(阪大産研)、岡本隠治氏(NEC 基礎研)、杉野修氏、大谷実氏(東大物性研)、 池庄司民夫氏(産総研)らとの共同研究で進めている。



図6 ロジウム原子層上の水分子吸着の異なる構造。



図7. Pt(111)表面と水との界面。

- [1] H. Ishii, K. Sugiyama, E. Ito, and K. Seki, Adv. Mater., 11, 605 (1999).
- [2] H. Ishii and K. Seki, in "Conjugated Polymer and Molecular Interfaces", edited by W.R. Salaneck, K. Seki, A. Kahn, and J.-J. Pireaux (Marcel Dekker, New York, 2002), p293.
- [3] Y. Morikawa, H. Ishii, and K. Seki, *Phys. Rev. B* 69, 041403 (R) (2004)
- [4] S. Yanagisawa and Y. Morikawa, *Jpn. J. Appl. Phys.*, in press.
- [5] S. Yanagisawa and Y. Morikawa, *Chem. Phys. Lett.*, to be published.
- [6] Y. Okamoto, O. Sugino, Y. Mochizuki, T. Ikeshoji, and Y. Morikawa, *Chem. Phys.Lett* 377 236 (2003).

メゾスコピック系の伝導現象の研究

独立行政法人産業技術総合研究所、物性研究所客員講師 中西 毅

今年度後期に、加藤岳生助教授に受け入れ研究所員になっていただき、物性研究所の客員講師を勤めることになりました。10年前、六本木にあった物性研で安藤恒也先生のポスドクとして約一年間滞在し半導体メゾスコピック系の電気伝導の研究を始めました。その後も物性研にたびたびお邪魔しながら、共同研究を通じて研鑽を積ませて頂きました。以下ではこれまで行ってきた、カーボンナノチューブとメゾスコピック系での電気伝導現象についての理論的研究を振り返ってみたいと思います。

カーボンナノチューブは 1991 年に NEC の飯島澄男先生が発見された、新しい擬一次元系です。2 次元グラファイトを 円筒状に丸めた構造をとり、直径は1nm 程度、長さは1µm から、最近では1mm 程度の物も報告されています。円周方 向の波数が量子化され、量子化された一次元バンドの間隔は円周に反比例し、1eV 程度になります。ですから室温でも電 子の運動がナノチューブの軸方向だけに制限され、一次元量子細線と見なすことができます。また、電子がフェルミエネ ルギーで交差する線形の分散を持ち、自由電子とは非常に異なった運動が特徴的です。

カーボンナノチューブの発見後すぐに安藤研の学生だった安食博志さんが、カーボンナノチューブの電子状態を、有効 質量理論により研究しておられました。90年代後半から沢山の研究が発表されるようになりましたので、それに先駆けた 大変重要な研究でした。有効質量理論でカーボンナノチューブのハミルトニアンは、ニュートリノのワイル方程式と同じ 形に表されます。カーボンナノチューブは、その巻き方によって金属的、半導体的な電子状態をとることが有効質量理論 により、説明されました。また、光吸収、格子ひずみの効果、磁場効果、AB効果などが明らかにされました。

しばらく遅れて私も、カーボンナノチューブの電気伝導について共同研究を始めました。まず最も基本的な問題として、 金属的カーボンナノチューブ上で不純物ポテンシャルによる電子散乱を調べました。不純物ポテンシャルがグラファイト の格子定数に比べてゆっくり変化する長距離型の場合、伝導電子が後方散乱されないいわゆるバリスティック伝導を示し ました。[1] つまり金属的カーボンナノチューブは抵抗のない理想的な導線です。この驚くべき結果を理解するためにベ リーの位相の一例としての理解など、幾つかの説明を試みました。[2] 詳しくは解説 [3]、レビュー [4] などをご覧下さ い。

一方室温では、フォノン散乱が重要になります。電子フォノン相互作用が調べられ、伝導電子の散乱は起こりにくく、 室温でも平均自由行程は 1µm の程度になることが明らかになりました。[5] この様に、カーボンナノチューブは電気伝導 が非常に良い、特異な一次元系であることが分かってきました。これらをふまえ、バリスティックな系であるカーボンナ ノチューブの熱伝導について、新しい物性の可能性を加藤さんと議論しています。

また、半導体メゾスコピック系の電気伝導に関する研究も続けています。最近、家、勝本研の大変興味深い実験結果に 触発され、関連する理論的研究を行いました。[6] 図1に示したような、リングに量子ドットが埋め込まれた系で、ファ ノ効果が観測されています。ファノ効果は連続状態と束縛状態の干渉効果です。それは、量子ドット準位との共鳴による 伝導度ピークの形が非対称になる効果として観測されます。その非対称性から、量子ドット状態の位相に関する情報が得 られますが、一次元モデルの簡単な予想に反して、量子ドットにかけたゲート電圧が変化するとき、似たような非対称性 をもつ連続したピークが観測されました。

それを説明するために図1に示したような現実的な幅のある2次元モデルを用い、電気伝導度をリカージョン法による 数値計算によってシミュレーションしました。[7] 図2に示すように得られた結果は実験結果を再現しました。リング中 の連続状態と強く結合した量子ドット状態と、弱く結合した状態の混在として、これらの結果を説明しました。この様に 実験研究者との議論を続け、関連する理論からの協力を続けていきたいと思います。今回客員で滞在している期間はもち ろんのこと、つくばエクスプレスが開通し、物性研と産総研のあるつくばの間は大変便利になりましたので、今後も続け ていきたいと思います。また A. Aharony と O. Entin-Wohlman も、同時期に客員として滞在されました。彼らもちょう ど同じ系を研究していましたので、磁場をかけたときの AB 振動について議論できました。

最後にポスドクの間一貫して共同研究させて頂いた安藤恒也先生、今回客員所員という非常に素晴らしい機会を与えて 下さった、加藤岳夫助教授をはじめとして、物性研スタッフの方々への感謝を持って本稿を締めくくりたいと思います。



図1 量子ドットを埋め込んだABリングのモデル。 等電位線を示す。太線はフェルミエネルギー に相当する。量子ドット内の「Gate」と示し た長方形領域にゲート電圧をかける。



図2 コンダクタンスの計算により示された非対称 なファノ共鳴ピーク。(+)、(-)で示された領 域内で、似た非対称性が示された。

参考文献

- [1] T. Ando and T. Nakanishi: J. Phys. Soc. Jpn. 67 (1998) 1704.
- [2] T. Ando, T. Nakanishi and R. Saito: J. Phys. Soc. Jpn. 67 (1998) 2857.
- [3] 中西毅、安藤恒也:日本物理学会誌 54 (1999) 621.
- [4] T. Ando: J. Phys. Soc. Jpn. 74 (2005) 777.
- [5] H. Suzuura and T. Ando: Phys. Rev. B 65 (2002) 235412.
- [6] 相川恒、小林研介、中西毅:日本物理学会誌 59 (2004) 682.
- [7] T. Nakanishi, K. Terakura and T. Ando: Phys. Rev. B 69 (2004) 115307.

重い電子系の研究と冷凍機

岡山大学教育学部、物性研究所客員助教授 稲田 佳彦

このたび、2005年度後期に客員研究員として物性研にお世話になることになりました。極限環境物性研究部門の上床先生、 辺土博士とともに「コンパクトな冷凍機を用いた高圧下磁気測定装置の開発」をテーマに研究を進めています。10月に着 任してあれこれ模索しているうちに、「物性研だより」への執筆依頼がありました。物性研での研究が何かしら形になった 時に、その成果を「物性研だより」で紹介できるのがベストなのですが、まだまだ進行途上。しかし原稿執筆は避けられ ない「運命」とお聞きしましたので、今思うことやこれからの計画等、まとまりがありませんが、いくつか書き綴ってみ たいと思います。今の研究が形になった頃に、またあらためて研究を詳しくご紹介できればと思います。

さて、表題の重い電子系ですが、磁性不純物の近藤効果が解明された後、1975年の CeAl₃[1]の発見を皮切りに f電子 系化合物に舞台を移して研究が進展してきました。cf 相互作用に起因する RKKY 相互作用と近藤効果は、前者は磁気秩 序を安定化する方向にはたらき、後者は磁気モーメントを遮蔽する方向にはたらくことで互いが競合する関係にあります。 近藤効果が優勢だと低温まで磁気秩序が現れず、重い電子状態へのクロスオーバーを起こします。少なくともセリウム化 合物ではそのように解釈されています。重い電子系では準粒子が非常に動きにくく、その方向も制限されている状態で、 そのように動きが制限された準粒子が特異な超伝導や特異な磁性等、豊富な物性を示すことで興味深い研究対象になって います。

ところで、セリウム化合物やウラン化合物の重い電子系物質を研究していると、時々、遍歴とは何か、局在とは何かと いう定義がわからなくなります(私が勉強不足だからかもしれません...)。いわゆる仮想束縛状態では、**f**電子の波動関数 は有限の値が外にしみ出していて **cf**相互作用が大切な役割を果たしています。あるいは、内側のポテンシャルの中に **f**電 子が有限の時間留まっているといえます。その時間(確率)が"十分"長ければ、Hund 則や結晶場で説明できるような 磁性を示すと考えるのが妥当だとすれば、"十分"な長さとはどれくらいなのか。仮に **cf**相互作用が摂動で取り扱える範 囲だとすると、一見、局在模型が成り立っているようにも見えるウラン化合物で、フェルミ面を形成する **f**電子をどう扱 うべきか...。

仮想束縛状態の束縛時間(ライフタイム)をパラメータにしてその大きさを変化させたときに、磁化率、結晶場やフェ ルミ面がどのように変化するのか、あるいは局在模型と遍歴模型が共存しているように見える領域が存在するのか等を知 ることができたら、心のもやもやが解消される気がするのですが...。これは tight binding 近似に取り込むことができる のでしょうか。

実験的には、同じ結晶構造等のできるだけ同じ舞台で 4f と 5f 電子の束縛時間の違いがどうなるのかを調べる必要があ ります。セリウムとウランでは f 電子数が異なるので、同じ結晶構造で物性を比較する対象としては良い組み合わせでは ありません。最近、プルトニウム化合物で重い電子状態が発見されましたが、うまく価数が合うのであればサマリウム化 合物が比較対象として使える可能性があります。HoCoGas型結晶構造ではサマリウムはしっかり磁気秩序を示しています。 どうにかして仮想束縛状態の束縛時間を短くして、プルトニウム化合物と同じようなことが起きるかどうか確かめたいと 思っています。今のところ、圧力を加えてもなかなか転移温度が動いてくれないので手強そうです。

ところで、重い電子系は特性温度が低いことが特徴の一つです。量子効果・量子統計性を十分に発現させるには極低温 実験が不可欠になります。私が東北大学の修士課程のときも、重い電子系の電子状態を研究するために、澤田安樹先生に 指導を受けながら³He-⁴He 希釈冷凍機システムの構築から始めました。数十キロの鉄板をかかえる大仕事から、25μmの 銅線でコイルを巻く極小仕事、炎の溶接作業や液体窒素を使った冷たいリーク探しなど、大小冷暑(?)織り交ぜた活動 を懐かしく思います。最近は市販の希釈冷凍機が増えてきて、自動運転やコンパクト型、トップローディング型等、工夫



図1(a) 一般的な希釈冷凍機とその原理の模式図



された便利な希釈冷凍機が出回る様になってきました。物性物理の実験では、測定条件や試料を頻繁に変えて実験する場合が多く、試料の着脱や冷却が簡便な希釈冷凍機が役に立ちます。そこを意識した便利な市販の希釈冷凍機も手に入る様になってきました。そんな中、辺土さん、上床先生と一緒に、コンパクトな³He-⁴He 希釈冷凍機を作って新しい実験方法を試してみようという話が持ち上がり、今に至っています。小さいだけならば、低温部の長さが 20cm 弱、単純な二重管熱交換器式で到達温度 50mK 位の希釈冷凍機は比較的簡単に自作できますが、外部にはシールドローターリーポンプ等のポンプやガス操作用の配管が必要です。小さいだけでなく十分な冷却能力を持たせるとなると工夫が必要です。既存の手法ですが、いくつかの手法を組み合わせてコンパクトかつ冷却能力もそこそこある冷凍機を開発してみたいと計画を進行中です。(できるだけ安く...)

冷却能力と最低到達温度は冷凍機の重要な性能指標ですが、様々な熱流入がある物性測定では冷却能力が重要になりま す。冷却能力 \dot{Q} は利用するエントロピー差によるモル当たりの冷却能力qと冷却反応率 \dot{n} [mol/s]の積で与えられます。 \dot{n} は通常の³He-⁴He 希釈冷凍機ならば³He の循環量になり、例えば、少し強力な冷却能力 300µW (@100mK) を得るため には 350µmol/s 以上で³He を循環させる必要があります。一方、最低到達温度は、相分離面のある混合器(M.C) にい かに低い温度で³He を導入するかで決まるので、熱交換器(H.E)の性能が重要になります。

図1(a)に³He-⁴He 希釈冷凍機の写真とその原理の模式図を示します。この写真の希釈冷凍機は私が修士の時に製作に携 わった装置で、冷却能力 500µW (@100mK)、³He 循環量 600µmol/s を想定して作られています。最低到達温度は 9mK でした。写真を見ると、500µW の冷却能力を得るために、大きなポンプと配管が必要なことがわかります。模式図のよう に、室温部には十分にコンダクタンスのある太い配管と強力なポンプが必要で、これがコンパクト化の妨げになります。 その解決方法として図1(b)の様にポンプを低温部に入れる方法が有効です。低温では気体のコンダクタンスが良くなるの で、配管を細くできます。更に、もし液体のまま³He を循環できたら、大量の³He 原子を細い配管のまま循環させること が可能になり、高い冷却能力の維持が期待できます。通常の³He 循環式³He-⁴He 希釈冷凍機の場合、分溜器 (still) で³He を気体の形で分溜するので、液体のまま循環させることはできませんが、⁴He 循環式希釈冷凍機ならば、気体状態を経る ことなく⁴He を循環させることができます [2,3]。⁴He 循環式では濃厚相と希薄相の熱交換に固体の隔壁が必要なく、熱 抵抗(カピッツァ抵抗)を小さくできるので大規模な熱交換器が必要ないという利点もあり、コンパクト化に都合の良い 条件が揃っています。その構造は、³He 循環式希釈冷凍機と大きく異なります。超流動 ⁴He のスーパーリークを利用して 分溜するというユニークな方式など色々面白そうなのですが、今回は ³He 循環式希釈冷凍機をベースに進めることにしま した。⁴He 循環式コンパクト希釈冷凍機は、これから先の楽しみにしようと思います。 今回は、活性炭等を利用した吸着ポンプを採用します。吸着ポンプを利用したクライオスタットの原理は 1939 年に Zamenhof より提唱され[4]、多くの³He クライオスタットの報告や希釈冷凍機の報告も行なわれています[5]。色々な工 夫もされており、最近では吸着ポンプを使った希釈冷凍機もいくつか市販されるようになりました。我々の冷凍機ではジ ュールトムソン効果(JT 効果)を利用した³He ガス液化方式も組み合わせて、理想的には、室温部に機械的ポンプが必 要ないコンパクトで軽量なスティック型希釈冷凍機にすることを目指しています。吸着ポンプの構造や動作方法などのテ ストを重ねる必要がありますが、どうにか完成にたどり着きたいと思っています。コンパクト化・軽量化された希釈冷凍 機に圧力セルを取り付けて、希釈冷凍機ごと動かして引き抜き磁化測定を行なうのが最終目標です(この半期では無理な ので将来の目標になりますが...)。それ以外にもコンパクト化を生かした測定方法を模索してみたいとも思っています。

私は今、教員養成学部に所属していて小中高等学校の先生の卵達と過ごしています。理科の先生、あるいは小学校で理 科を担当する運命にある学生たちですが、どうにか魅力的な先生に育ってもらいたいと願っています。今、彼らに最も必 要なものは科学的センスだろうと思います。知識レベルもまだまだですが、科学的センスがないと有意義な授業を組み立 てることが難しいだろうと思います。共同研究や普段のディスカッションの進め方など少しでも肌で感じてもらいたいと 思っています。そして科学好きの子供を一人でも増やしてもらいたいと思います。そういう意味でも、このたび、物性研 で冷凍機の開発等の機会を得ることができて、とてもうれしく思います。よろしくお願いいたします。

とりとめのない文章で失礼いたしました。

- [1] K. Andres, J. E. Graebner and H.R. Ott : Phys. Rev. Lett. 35 (1975) 1779
- [2] N. H. Pennings et al.,: Physica B 84 (1976) 249.
- [3] 佐藤武郎 他: 固体物理 19 (1984) 594.
- [4] S. Zamenhof : Physica. 6 (1939) 47..
- [5] V.A. Mikheev et al.,: Cryogenics 24 (1984) 190.

外国人客員所員を経験して

大学共同利用機関法人自然科学研究機構 分子科学研究所客員教授 Makariy TANATAR

My stay at ISSP as a Visiting Professor of the Megagauss Magnetic Filed Laboratory (host Professor Toshihito Osada) lasted for 7 month, starting from June 1, 2004. I enjoyed a nice opportunity to do experiments using incredible facilities of the pulsed magnetic field laboratory, and in addition to perform collaborative studies with the laboratories of Professor Hatsumi Mori, Professor Sakakibara and Professor Uwatoko. I had a chance to communicate with a number of people working on heavy fermion and organic superconductors. These were very useful collaborations and discussions, and I am grateful to my colleagues for that.

Since professor Ishimoto requested me to express my opinion about the work of ISSP, I would say that it is perfectly organized in the most of respects. This covers all the range from the machine shop in the basement to the library at the top, not to forget to mention International Liaison Office, which for the visitor is right at the centre.

Here I want to focus on a problem, which I see as common for ISSP, and which seems both important and easy to fix. In my opinion, there is an evident shortage of effective scientific communication, both inside ISSP and especially with the visitors. Of course, in part this is a problem of too beautiful and spacious building, when people rarely meet each other by chance. For younger members it may be in part a language barrier. But there is a notable room for improvement, especially when we talk about the visitors.

It is a common practice for a visitor in North America to have organized discussions out of the seminar format. In addition to a seminar talk, every visitor is involved in a sequence of individual discussions, typically 30-40 minutes long, with everyone interested. The schedule of these meetings is prepared by the secretary of the seminar, or, in some cases, by the host Professor. It typically includes 10 to 15 people on the list. Actually, the most important discussions usually proceed in this format.

These short meetings have several advantages. They provide a chance to introduce your own research to the visitor. They give a chance of more informal discussion of the subject of the seminar, when asking stupid questions does not impact your image in the eyes of the colleagues, something many people are hesitant to do. Or this may be a perfect chance to discuss whatever other topics of interest, which are not necessary related to the subject of the seminar.

Of course for the most popular personalities this list is actually limited to senior faculty, but in the most of the cases it is accessible for everyone starting from Post-Doc level. This form is especially useful when theory seminars are made, which are particularly difficult to follow without some one-on-one explanation. Of course, this makes a visitor to put an extra effort in explanation of his work and to make it accessible to the audience. It can easily happen that the visitor schedule is tense, in which cases some groups are making short 5-10 minutes presentations by all group members, to show the work of the laboratory.

The second form is present to some extent in ISSP, but it is evidently underrepresented. This is an exchange of the speakers between different seminars inside ISSP. This is particularly useful for communication between theory and experiment. Although this is internal communication, and there are no barriers separating different laboratories, sometimes it is useful to have it organized in a similar way.

I enjoyed my stay at ISSP, and I am thankful to all members of ISSP for giving me with this nice opportunity.

外国人客員所員を経験して - My vision of Japan-

Rashid GANEEV Academy of Sciences of Uzbekistan, Principal Research Scientist, Uzbekistan

"Days and months are eternal travelers, As are the years that come and go."

This excerpt from the poem "Oku no Hosomichi" of Japanese writer Basho describes my feelings when I reconsidering my stay in this beautiful, friendly country. Your motherland comprises a lot of wonderful natural and historical places, which I visited: a charming Kyoto with well-preserved old pagodas, temples, and shrines (among them the Golden pavilion, Sanjusanjendo and Ryoji temples are among those that inspired my admiration), quiet Nara with deer parks, Nagoya castle, Nikko ensemble, Hakone area, great Buddha in Kamakura, Oze marshlands, and of course, Fuji-san, - which I climbed during my stay here, - a natural monument underlining the beauty of your land. When I remembering my trips around these places I always regretfully acknowledge that the lack of time did not allow me visiting Hokkaido, Okinawa, and many other places. However, at any moment of my stay here I was benefited by most important jewelry of this country, - their people. The friendly Japanese, whose hospitality helped me both in my everyday life and my studies in the Institute for Solid State Physics, always surrounded me.

Unfortunately, I could not succeed in the studies of Japanese language, probably due to some personal problems of linguistic education. However, it did not prevent me in exchange of opinions with different kinds of folk. Anyway, the English helped me communicating with my colleagues in ISSP and people surrounding me.

Back to my stay with ISSP, I would like to underline the well-established systems of Visiting Professorship and Foreign Scientists Fellowship both at the laboratory and institute levels. From the early days of my stay with ISSP I met a warm welcome from Professor Kuroda and staff of his laboratory. I could not say anything but heartfelt gratitude to Mitani-san, Baba-san, and Suzuki-san for their help in everyday life. During all this time I had a constant contacts with Professor Kuroda and was learned from him about many peculiarities of both Japanese life and sophisticated scientific problems.

Bay the way, the topics of my studies here were related with laser-matter interaction. However, most important impact I have received from the people-to-people interaction. As above-mentioned Japanese wisdom reminded, the years are go, so the most important memory that left after a stay in your country is my communication with local people.

This excellent atmosphere created by Japanese hosts for foreign scientists leads to so-called feedback loop. Such conditions almost automatically lead to the growth of "productivity" from foreign guests. I was told with many foreign colleagues on that matter and everybody could admit that the stay in this excellent institute gave a strong impact both for host laboratory and foreigners. As for me, I have published more than ten papers based on the studies in Professor Kuroda's laboratory.

This result could not be achieved without the support of institution authorities and their branches. Among them the International Liaison Office plays without any doubts a leading role in every aspects of the life of foreigners in the frames of institute's programs. From the beginning I was surrounded by the care of the ILO staff. See, how many different activities they offered. These are the arrangements of different events starting from welcome party to farewell party, tours to Kashiwanoha Park's Japanese Tea House, sushi and language lessons, ikebana exhibitions, various arrangements on the trips around Kashiwa, etc. Just recently we made an interesting trip in Tsukuba area and climbed on the Tsukuba mount. And it should not be forgotten to mention about almost everyday submission of valuable information by e-mails concerning the scientific seminars, meetings, and conferences held in the institute and around, that could not be underestimated taking into account the difficulties that met foreigners due to the problems related with Japanese language.

And all this could not be achieved without our dear members of ILO. Any time when I coming in the ILO office I meet the bright smiles of our dear Kameda-san and Oguchi-san. I could not account the number of cups of green tea that they served for me immediately after my meeting with them in their office. Their knowledge and advises many time helped me, especially in veryday life. I could remember their help in finding the convenient swimming pool for my family, orrowing different furniture and appliances, and many, many other. May I wish to these two beautiful women: "Dear Kameda-san and Oguchi-san, please remain the same smiles for a long time to delight everybody surrounding you! You are very special for us, foreigners."

I would like thanking everybody in this institute who helped me to be a rich man from the point of view of the knowledge of Japan, Japanese culture, and Japanese people.

外国人客員所員を経験して

梨花女子大学(韓国) 物理学科教授 Woun KANG

For eight months in the ISSP, I enjoyed much its abundant research environment. The Kashiwanoha park, just a few steps way from the Institute, was also an important resource for research in that it can make one refresh from the afternoon fatigue.

It I say something on the ISSP only after a brief stay for which I have stayed enclosed mainly inside one research group, I am afraid if it may mislead. It is not arguable that the ISSP is one of the best research facilities both in human and material resources. The activity was also hot. There has been at least three series of seminars in the group. There have been more seminar announcements on the elevator wall all the time. The only thing that I thought was that the lab could have more students and staffs. Compared with the abundant research infrastructure, I felt that there were not enough people around to use it. But, I believe that the newly inaugurated Tsukuba Express will bring more students and researchers to the ISSP. It was really a good progress to be able to get Tokyo within half an hour. It will also make it easier the collaboration with groups in Tsukuba area.

Just one minor thing that I want to see in the ISSP is to promote the exchange between research students. It is very important because the students now in this field may contribute to the other fields later. Compared with many in-group activities, I do not find as much inter-group activities. Organizing regular (quarterly, for example) seminars in which all the research students report their progress in thesis, discuss it with their compatriots, know each other better, and acquire knowledge for related and/or different topics may make them healthy in science.

It will be very nice to me to get another occasion to return to the ISSP and continue to work together.

研究室だより ―日本化学会学術賞への歩み―

附属中性子科学研究施設 柴山研究室 柴山 充弘

「物性研に着任して」という記事を物性研だより(第40巻 第5号 2001年1月 p.1-6)に書いてから5年が経過 した。「東海と柏の勤務地二重性、研究と装置管理と教育という3軸上での最適化問題など」の解を得るにはまだ至って いないが、着任後5年という節目にあたり、研究室のあゆみを人の流れを通じて振り返るとともに自己採点をしてみたい と思う。

1.ゼロからの出発

私の研究室のミッションは東海村日本原子力研究開発機構の研究用原子炉JRR-3Mのガイドホールに設置された2次元 小角中性子散乱 SANS-U と中性子スピンエコーISSP-NSE(現 iNSE)の装置を使った研究を展開するとともに、全国共 同利用の支援を行うことである。多くの所員がそうであったように、私の場合も全く一人での研究室の立ち上げとなった。 さらに勤務地の二重性が予想以上の障害となったスタートであったと思う。2000年9月1日、京都からの荷物は東海の 私の部屋、柏の自室と実験室、それにつくばの官舎の3カ所へと送られてきた。当然、生活のための官舎への引っ越しを 最優先とし、次に東海の研究室での書類の整理と続いた。そうしている間にも SANS-U の共同利用の推進が休むことなく 続いていたため、東海では長尾道弘助手に SANS-U の使い方や共同利用のスケジュール管理などを教えてもらいながら、 共に運営を開始した。一方、柏では新しく買った試薬保存用の冷蔵庫を設置して電源を入れるだけでも3ヶ月もかかって しまった。別に怠慢であったからではなく、東海での共同利用推進のため、柏でじっくりと研究室造りをする時間すらな かったからである。柏出張はもっぱら会議のためであり、会議が終われば、東海の研究室かつくばの官舎に帰るという生 活だった。そんな生活にたまりかね、京都に残してきた博士課程の学生であった高田慎一君(当時 D2)と増井直樹君(当時 D1)に応援を頼んだ。彼らは私の申し出を快く受けてはるばる柏に来てくれた。彼らのおかげで物性研へのソフトランディン グができ、東海での共同利用と柏での試料調製、動的光散乱実験を行う体制を2001年4月までに作り上げることができた。

2. 高分子ゲルの不均一性の研究の継続と発展

高田君は、「環境敏感型高分子ゲルの構造と、 ダイナミクス、及び物性に関する調製条件依存 性の研究」と題した学位論文研究の中で、調製 温度や架橋密度を変えた一連のゲルを調製し、 それらの不均一性を小角中性子散乱(SANS)、 および動的光散乱(DLS)でつぶさに研究した。 また、乳性タンパク質のゲル化の研究などを行 ってくれた。図1はSANSおよびDLSで評価 したゲルの動的ゆらぎと静的不均一性の比を散 乱ベクトルの絶対値 qに対してプロットした図 である⁽¹⁾。図中の数字は架橋剤として用いた N,N'-メチレンビスアクリルアミド(BIS)の濃 度 C_{BIS}(mM 単位)を示している。<I_F>T/<J>E は 光散乱(LS)より求めた散乱強度の動的成分の 時間平均成分<I_F>T とアンサンブル平均強度



図1. ゲルの不均一性の散乱ベクトル依存性

<▶ の比である。一方、*G(q)/S(q)*は中性子散乱から 評価した散乱の動的成分 *G(q)*と全散乱強度 *S(q)*の 比である。*q*の大きな中性子散乱領域では散乱強度 のうちで動的成分が占める割合が大きいが、*q*が小 さくなるにつれて不均一性が増大することを示して いる。そしてその傾向は *C*BIS が大きいほど顕著であ ることを示している。これはゲルを右図のようなブ ロッブの集合体と考えたとき、ブロッブ内では均一 だが、ブロップより大きなところで不均一性が現れ



図2. 化学架橋ゲルと放射線架橋ゲルの比較

て、空間スケールが大きくなるにつれ、不均一性が増大することを実験的に示している。このように、不均一性は *q* の関数であることがわかった。高田君は 2002 年 3 月に博士論文を提出し、NIST へ留学していった。

増井君は、架橋剤によってゲル化させた化学架橋ゲルと放射線照射によってゲル化させたガンマ線架橋ゲルの構造・ダ イナミクスの比較、アルコール/水中におけるゲルの凝集性の研究などの成果をまとめて学位論文を仕上げた。彼の論文題 目は「中性子散乱および動的光散乱による高分子ゲルの構造と不均一性の研究」であり、2003年に学位を取得した。興味 深いことに、4 官能性架橋剤を用いた化学架橋ゲルとガンマ線架橋による放射線架橋ゲルでは、その微細構造は大きく異 なり、化学架橋ゲルの方がはるかに不均一性が大きいこと、また、架橋剤の添加により不均一性の増大の程度が著しいこ となどが分かった。図2はその結果を示している⁽²⁾。図中の SANS 強度関数のシンボルは実験点、曲線は不均一性を取り 入れたゲルの散乱関数の理論(Panyukov-Rabin 理論⁽³⁾)に基づく理論曲線を示している。このように、ゲルの不均一性が 理論によってうまく説明できることがわかる。

3.水溶性ブロック共重合体水溶液の物理ゲル化とミクロ相分離

大阪大学大学院理学研究科の青島貞人教授(平成 14 年度物性研 客員教授)らはポリ(2-エトキシエチルビニルエーテル)(EOVE) とポリ(2-ヒドロキシエチルビニルエーテル)(HOVE)から成るブ ロック共重合体(EOVE-HOVE)を合成した。このEOVE-HOVEの 水溶液は約 20°C で流動性が大きく変化し、さらさらの溶液が僅か 数 °C の温度上昇により剪断弾性率にして 4 桁以上も変わる。 EOVE が 20°C 付近に LCST(下限臨界共溶温度)をもつので、こ の温度付近で EOVE がミセル化することで物性変化が起こること はわかっていたが、その詳細については全く未知であった。この現 象を構造学的見地から研究してみたいという好奇心が共同研究の始 まりであった。そこで、2001 年 4 月に配属となった修士課程の岡 部哲士君にその研究を託した。彼はこの EOVE-HOVE 水溶性ブロ ック共重合体を対象にして、温度誘起ミクロ相分離・ゲル化につい ての系統的な研究を始めた。重水を溶媒として測定した小角中性子 散乱からは、図 3 に示すように、わずか数 °C の間に散乱関数は *q*



図3. 相転移の証拠となる中性子小角散乱関数の変化。 単調な散乱関数(15,16°C)から、球状粒子を持 つ系(17~19°C)、ミクロ相分離系(20,21℃) へと移転する。

の小さなところで強度が数桁も強くなり、単調減少関数から複数のピークを持つ特徴的な関数へと変化した⁽⁴⁾。さらに、 小角側でのピーク帰属から体心立方格子を組んだミクロ相分離構造を形成していることが分かった。こうした実験結果よ り、EOVE-HOVE は図4に示すように、分子分散状態からミセルを形成し、20°Cではミセルが規則正しく配列した超格 子構造へとミクロ相分離転移を起こすことがわかった⁽⁵⁾。このような鋭い転移は有機溶媒中でのブロック共重合体のよう なファンデルワールス相互作用系では見られないことから、EOVE 鎖の脱疎水水和による凝集がミセル化およびミクロ相 分離転移に強く関与していることが示唆された。岡部君はこの研究成果を2003年11月に物性研で開催された国際ゲルシ ンポ 2003 で発表し、ポスター賞を受賞した。

2002 年には布施千絵子さんがメンバーと して加わり、温度誘起相転移のみならず、水 誘起相転移の研究を展開した。彼女の試料は 上述の試料をより疎水性化したポリ(2-フェ ノキシエチルビニルエーテル) (PhOVE)とポ リ(2-メトキシエチルビニルエーテル) (MOVE) から成るブロック共重合体 (PhOVE-MOVE)である。この系は PhOVE が水に不溶のため、アセトンを共通良溶媒と し、水を添加することで PhOVE ミセル形成、 PhOVE ドメインをもつミクロ相分離構造形 成への転移を起こす。そこで、温度誘起型相 分離の研究で培った手法をそのまま応用し、 水添加による構造形成の研究を行った。その 結果、温度誘起型と水誘起型ではミクロ相分 離形成に大きな違いが現れてくることが発見 された。この現象をより詳しく研究するため に、親水性ブロック成分を MOVE に統一し た 2 つの系 PhOVE-MOVE、EOVE-MOVE について水誘起相分離、温度誘起相分離の過 程での散乱関数の変化を調べた。その結果を 図5に示す(6)。水誘起型相分離はゆらぎの増 幅により相分離が進行するスピノーダル分解 型であるのに対し、温度誘起型はミセル形成 が先でその後、粒子の配列が起こる、いわゆ る核形成・成長型であることがわかった。こ の違いも相分離がファンデルワールス型か脱 疎水水和型のいずれに属するかに依存してお り、水誘起型は疎水性ブロック鎖があっても



図 4. EOVE-HOVE の構造転移モデル図



図 5. 水誘起型と温度誘起型相分離の違いを示す小角中性子散乱 曲線。PhOVE-MOVE/アセトン/水と EOVE-MOVE/水

溶媒がアセトンであるため、ファンデルワールス相互作用の変化によって相分離が誘発されたと理解できた。布施さんは、 2004 年 3 月、新領域創成科学研究科物質専攻の修士論文発表会にて修士論文優秀講演賞を受賞し、東レに就職していった。 こうしたブロック共重合体と溶媒との相互作用に基づく構造形成の研究は、2004 年にメンバーとなった大坂昇君へと受け 継がれていった。

4. 圧力誘起相分離と疎水性水和

1990 年代初め、私はマサチューセッツ工科大学留学中に NIST (米国標準技術研究所) へ出張し、N-イソプロピルアクリル アミド(PNIPA)ハイドロゲルおよび PNIPA とアクリル酸との共 重合体 (PNIPA-AAc)ゲルの小角中性子散乱を行った。そのとき、 PNIPA ゲルでは 2 次転移が起こり 3 次元 Ising 的な臨界現象が観 測されるのに対し、PNIPA-AAc では一次転移を伴うミクロ相分 離が起こることを発見した^(7,8)。ポリ NIPA (PNIPA)水溶液は下 限臨界相溶温度 (LCST)を約 32℃ に持つため、PNIPA ゲルは その温度付近で膨潤状態から収縮状態へと体積を連続もしくは不 連続に変化させる「体積相転移」という興味深い現象を示す。以 来、10 年余り、この熱敏感型高分子の虜となり、力学、赤外分光、



図 6. 小角中性子散乱用圧力セル

熱測定、膨潤・収縮の速度論などといったいろいろな観点から研究を進めてきている。

通常、LCST をもつ高分子ブレンド系は顕著な圧力依存性を持ち、 静水圧印加によって相溶性が変化することが知られている。そこで、 2002 年にメンバーとなった磯野光司君に PNIPA 水溶液および PNIPA ゲルの圧力下での相分離の研究をやってもらった。その研究 には所長裁量経費で購入した小角中性子散乱用高圧セル(写真:図 6) が威力を発揮した。ゴムのダイアフラムをもつインナーセルに 試料を詰め、これを高圧セルにセットしてハンドポンプで加圧する と、容易に 300MPa まで昇圧することができる。このセルを使って 小角中性子散乱実験を行った。その一方で、柏には科研費で光散乱 用高圧セル(写真:図7)を購入し、曇点測定による相図作成、動 的光散乱による高圧下での高分子溶液およびゲルのダイナミクスの 研究を展開した。その結果、図8に示すように、高分子溶液とゲル のいずれもが、圧力 P、温度 Tの平面上で上に凸の曲線を描く相図 をもつことがわかった(9)。しかも、溶液とゲルとではその相図が異 なり、ゲルの方がより高圧、高温まで一相状態を取ることが確認さ れた。さらに、溶媒を軽水から重水に置き換えると、相図が約1.5℃ 高温側にシフトする同位体効果も観察された。一方、小角中性子散 乱実験からは、(1) PNIPA 溶液では明確な圧力誘起臨界現象が観測 され、相関長の発散が起こること、(2)発散の手前でバイノーダル による相分離が起こることが確認された。これらのことから、 PNIPA ゲルでは架橋の存在のため圧力印加による不均一性の増大 が顕著であり、相分離はより顕著な圧力依存性を示すと結論した。

この研究は、2003 年 6 月から 1 年数ヶ月、非常勤研究員として 滞在した Irina Nasimova 博士(現モスクワ州立大学物理学科助手) によって引き継がれた。彼女はアクリル酸との共重合体である、 PNIPA-AAc ゲルについて温度、圧力の関数として、小角散乱関数

を測定したところ、加圧によりミクロ相分離によるピークが一旦 100PMa あたりで消滅し、その後、再び現れるという再 帰現象を発見した。これは、ホモポリマー系において磯野君が観察した不均一性の再帰性に相当するもので、圧力が疎水 性基をもつ水溶性高分子の構造に与える効果は決して単純なものではないことを強く示唆した結果である。この Nasimova 博士の研究は、大坂昇君に引き継がれていく。

磯野君、Nasimova さんの研究はホモポリマーもしくはランダムコポリマーを対象としていたので、温度や圧力に対す る系からの応答として、相溶性や不均一性の変化という情報でしか得ることが出来なかった。それに対し、ブロック共重

合体を使うと、それぞれのブロック成分が環 境因子としての温度や圧力に応答するため、 疎水性水和をナノメートルオーダーで研究で きると考えた。そこで大坂君にブロック共重 合体水溶液の圧力誘起相分離の研究をやって もらうことにした。まず、青島先生に研究の 目的を話し、議論した結果、EOEOVE-MOVE というブロック共重合体が最も研究に適して いるだろうということになった。EOEOVE は約 40°C に LCST を持っているため、室温 では溶液状態であり、試料のハンドリングが 容易であった。EOEOVE-MOVE 水溶液の相 図を作成すると、予想通り圧力に対して凸関 数の相図が得られた。ただし、この系は 40°C 付近にミクロ相分離転移曲線が現れ、さらに



図 7. 光散乱用圧力セル



図 8. PNIPA 水溶液の圧力ー温度相図。高分子溶液、 ゲルおよびそれぞれの重水中での挙動。



図9. EOEOVE-MOVE 水溶液の圧力ー温度相図と対応する SANS 曲線、加 圧、加熱によってそれぞれ異なる構造が出現することが SANS 実験によ り発見された。

高温の 65°C 付近に MOVE 鎖の凝集に伴う相分離曲線を持つことがわかった。そこで小角中性子散乱は当初の目的である 圧力誘起ミクロ相分離の研究に集中した。測定結果の一例を図 9 に示す。この系は(i) 低温での加圧により相関長の発散 を伴う相分離をする。また、(ii) 大気圧中での昇温によりミクロ相分離転移が起こる。さらに、(iii) ミクロ相分離転移温 度より高温での加圧により、一旦、ミクロ相分離は消滅するが、さらに加圧を続けると再びピークが現れるという、再帰 的相分離が起こることが分かった⁽¹⁰⁾。しかし、今のところ、この高圧相の構造は不明であるので、大坂君の博士論文テー マとしてさらに研究を展開していく予定である。

5.オイルゲル化剤

オイルゲル化剤とは特殊な有機化合物で、1%程度の特殊な 化合物を添加するだけでアセトン、トルエン、メタノールなど の多くの"溶剤"が固化してしまう。オイルゲル化剤としては、 溶媒中で結晶化しないような対称性の低い分子構造であること、 有機溶媒に溶けるアルキル基などを持っていること、そして自 己集合性を駆動する官能基、たとえば水素結合、を形成するア ミド基を持つことなどが分子設計の観点から要請される(図 10)。さらに、分子に光学活性部位が必要であることも、ゲル 化する化合物の分類や電子顕微鏡観察結果から分かってきてい た。オイルゲル化剤の合成で著名な信州大学の英教授グループ



図 10. オイルゲル化剤の化学構造の例

はそうした要件を満たす化合物としてアミノ酸誘導体のゲルを多数提案している。私は「ゲル化する系なら何でも調べて みよう」という研究方針をもっているので、ゲル化剤によるゲル化についての共同研究を申し出た。ちょうど博士課程に 進学した岡部哲士君の格好のテーマとして、SANS、DLSによる研究を徹底的にやってもらった。その結果、オイルゲル 化剤による有機溶媒のゲル化は、ある温度でSANS強度がべき乗関数的に増大し、自己相似的な構造が出現することによ って起こることがわかった⁽¹¹⁾。また、DLSからは運動性が低い、いわば固体的(ガラス的)な構造体が出現することが分 かった。透過型電子顕微鏡観察結果と合わせると、オイルゲル化剤によるゲル化は、針状の集合体が系中に析出し、それ が樹枝状に成長して空間を充填することで、多量の溶媒を閉じこめるというメカニズムによって起こることが分かった。

その他、昨年にはインドから学術振興会招聘研究員で大阪大学に滞在していた Dastidar 博士との共同研究をおこない、 高いゲル化能をもつ胆汁酸誘導体と2級アミンからなるゲル化剤についてのゲル化の研究も行った。通常のゲル化剤は、 50°C以上に温めた溶媒にゲル化剤を添加し、それを冷却することによりゲル化を行うが、胆汁酸誘導体の場合では、2液 混合型のゲル化剤であるため、加熱、冷却などの操作を必要としないことが特徴的である⁽¹²⁾。

6.スーパーゲルの構造解析、ダイナミクス、変形挙動

2003 年、CREST 伊藤プロジェクトの狩野武志博士がメンバーに加わり、 環動ゲルの構造とダイナミクスの研究を展開した。環動ゲルとは、ポリエチ レングリコール (PEG)分子を環状化合物であるシクロデキストリン (CD)に 貫通させてできるポリロタキサンを構成成分とするゲルである。その構造を 図 11 に示す。ポリロタキサン中の CD は PEG 鎖から抜け出していかないよ うに両末端はかさ高い置換基で塞がれている。また、異なる鎖上の CD が化 学結合によって繋がれており、これが分子鎖を結びつける架橋点として働く。 通常、この架橋点は鎖上の固定点である。これに対し、環動ゲルでは引っ張 りや膨潤などの外部からの負荷に対し、網目の歪み分布を最小にするように "架橋点"は網目に沿って自動的に動くと考えられる。その結果、従来のゲル に対し、より大きな膨潤能や高延伸性などが期待できるわけである。実際、 環動ゲルでは乾燥重量の数万倍という膨潤能や数十倍という延伸性などの記 録的な値が観察されている。しかしながら、図 11 で示したような構造が本 当に出来ているのかを証明する必要が開発当初からあった。そこで、我々の



図 11. 環動ゲルの構造模式図

グループは狩野研究員を中心にこの環動ゲルの実証実験および、変形挙動の微視的観察の研究をすることとなった。

研究を始めてまもなく、動的光散乱によりスライディング モードを発見した。通常のゲルだと架橋点間の部分網目鎖の 運動を示すゲルモードといわわれる協同拡散モードと網目全 体の並進拡散モードの2つが観察される。しかし、環動ゲル にはその2つのモードの間にもう一つのモードがあることが 観察された。さまざまな検証実験の後、これは可動架橋点が 分子鎖上を滑るスライディングーモードであることを確認し た。最近、狩野研究員は小角中性子散乱によって環動ゲルの変 形挙動をつぶさに研究して興味ある成果を次々と挙げている。 図12は変形ゲルの2次元理論 SANSパターンを示している。 延伸に伴って、散乱パターンは縦に伸びていっていることが わかる。通常のゲルでは延伸により延伸と同じ方向の散乱強



図12. ノーマルバタフライパターンとアブノーマルバタフライ パターン。ノーマルパターンは延伸下(流動場)での高分子 からの散乱で見られる。一方、アブノーマルパターンは ゲルの不均一性に由来する、延伸方向に平行な散乱が強 くなる。

度が強くなる、いわゆるアブノーマルバタフライパターンが現れる(図 12 右)。それに対し、流動場下の高分子溶液やバ ルク高分子を溶融状態で延伸した後に急冷して固化させた試料の中性子散乱実験を行うと、流れの方向に引き延ばされた 高分子鎖が観測されるためノーマルバタフライパターン(図 12 左)が現れることが知られている。ところが、図 12 と 13 を比較してみれば分かるように、環動ゲルはゲルであるにもかかわらず、ノーマルバタフライパターンを示しているこ とがわかる⁽¹³⁾。これは、環動ゲル中の高分子鎖が非常に溶液的、換言すると、「架橋点の束縛のない状態」にあることを 示している。したがって、中性子散乱からも環動ゲルの「環動性」あるいは「可動架橋点の存在」が証明された。また、 図 13 はゲルにおいて初めて観測されたノーマルバタフライパターンである。さらに面白いことに、網目状の架橋点の数 を増やしていくと、ノーマルからアブノーマルバタフライパターンへの転移が起こることも確認されている。これは、網 目密度が上がるともはや架橋点はスライド出来なくなり、従来のゲルと同じような変形挙動を示すからと推測できる。 この研究はまだまだ興味ある展開をしていくだろう。

環動ゲルと並んでもう一つナノコンポジットゲル (NC ゲル) と呼ばれる PNIPIA とクレイ (無機鉱物) から成るスー パーゲルが開発された。厚み 1nm のクレイ板を分散した水溶液中で NIPA をラジカル重合させると、クレイが架橋点と なり、強靱なゲルが形成される。このゲルの強さは驚異的で、水が 90%入っていても 10 倍以上も延伸可能であるし、紐 のように結ぶこともできる。この興味あるゲルの構造解析は、2003 年にメンバーとなった須田淳子さんが行った。彼女は クレイ濃度が異なる一連の NC ゲルを調製し、

中性子散乱と光散乱により、構造の架橋密度依 存性を調べた。その結果、ゲル化により、それ ぞれの散乱では説明できない構造が形成されて いることがわかった。

しかし、NC ゲルの驚異的な力学物性を知る には、延伸下でのゲルの構造を調べる必要があ ることを痛感した。そこで、狩野研究員、岡部 君らとともにNC ゲルを延伸しながら小角散乱 実験を行った。しかも、クレイの散乱を消した 状態で高分子鎖の配向だけを選択的に調べるた めに、溶媒の散乱長密度をクレイに合わせたコ ントラストマッチした条件での実験も行った。 その結果、NC ゲル中の高分子鎖はまるで流動 場の中にある高分子鎖のように引き延ばされ、 しかも分子量が大きいため高延伸可能であると



図13. 環動ゲルのノーマルバタフライパターン。
 ポリロタキサン濃度 10wt%、溶媒は重水素化 DMSO。
 架橋剤濃度 C_{*}=1.0%。

いうこと、そしてクレイはそうした高分子鎖がバラバラになることを防ぐ束 の役目を果たしていることなどが解明された⁽¹⁴⁾。この考えは新規なスーパ ーゲルの創成につながるものと期待され、さらなる研究を展開中である。

7.マイクロエマルションの構造解析と圧力誘起構造相転移

私が物性研に着任する前から長尾助手は SANS-U 及び ISSP-NSE を用い てマイクロエマルション系の研究を行っていた。この系は水、油とともに両 親媒性分子を混合する事によってナノスケールの自発構造を形成する事が知 られているが、その圧力誘起転移のメカニズムは明確にされていなかった。 マイクロエマルションの中でも陰イオン性界面活性剤 AOT/水/デカンか らなる系は、室温常圧で広い一相の油中水滴構造を形成する。散乱データは 粒子形状因子と構造因子の寄与からなっているが、濃度の増加とともに構造 因子の影響が強くなり、形状因子そのものを評価する事も難しくなってくる。 そこで、彼は中性子コントラスト変調法を利用すれば構造因子の仮定なく粒 子形状因子を求められる事に着目し、新たな解析法(相対形状因子法)を提 案した。そして、この方法により形状因子と構造因子の分離に成功した⁽¹⁵⁾。 この解析法は構造因子の仮定を用いない点で画期的であり、今後様々な系に 対して構造因子の見積もり、すなわち粒子間のポテンシャルの見積もり等に 利用されるものと期待される。



 図14. アップグレード後の SANS-U の制 御画面の一部。(a)2次元散乱パタ ーンがリアルタイムで表示され、
 (b)その円環平均強度が画面左下 に刻々表示される。

また、非イオン性界面活性剤 $C_{12}E_5/\pi/オクタン系では、加圧あるいは降温によってラメラ構造からヘキサゴナル構造への相転移が観測される事が明らかになった。これらの転移に伴う SANS データの解析から、圧力変化の場合、両親媒性分子の疎水基の圧縮に起因して、膜の持つ自発曲率変化が誘起され構造変化に至る事がわかった。一方、温度変化の場合は熱膨張係数から見積もられる体積変化のみで自発曲率変化を説明する事は出来ず、熱揺らぎに起因する他の効果が影響を及ぼしている事が示唆された⁽¹⁶⁾。両親媒性分子膜は熱揺らぎによって波打ち運動をしているのだが、この波打ち運動の緩和時間は膜の弾性率によって決まっている。長尾助手は NSE を用いた膜のダイナミクスの観測から、加圧による膜の弾性率の増加、すなわち、膜の硬化の描像を捉える事に成功した。この事は、圧力印加により膜内の分子密度が上昇する事に伴って発生する硬化現象であると考える事が出来る。この描像は先に示した AOT 系の場合の膜のダイナミクスと同様であり、両親媒性分子膜が普遍的に持つ圧力効果として捉える事ができる。長尾助手はこれらの功績により、2005年11月に第3回中性子科学会奨励賞を受賞した。さらに最近では、このようなマイクロエマルションとゲルの融合系とも言える、ゲル中に秩序的な構造を閉じ込める研究(ゲマルション)も新たな対象として現在進行中である。$

8. 非干渉性散乱の評価法の研究

物性研に着任した当時から、中性子散乱のデータ補正に使う軽水の絶対散乱強度に厚み依存性があることが気になって いた。絶対散乱強度とは微分散乱断面積とも呼ばれる示強量である。したがって、それが厚み依存性を持つということは あり得ない。共同利用実験の合間合間に長尾助手とともにその理由を調べるという地味な実験をおこなった。その結果、 測定される絶対強度はみかけの絶対強度であり、実際には水素原子からの非干渉性散乱による非常に強い多重散乱が起こ っていることがわかった。水からの散乱が多重散乱であることは周知の事実であったが、それを補正する有効な方法がな かったのである。さまざまな検討の末、我々は理論補正式を導出し、厚みの違うポリエチレン板や軽水と重水の混合溶液 などの実験によりその妥当性を確認した⁽¹⁷⁾。今後、この式が中性子散乱のバックグラウンド強度(非干渉性散乱)補正に 広く使われることになると期待している。

9.SANS-U及び iNSE の高度化

SANS-Uは 1993 年の共同利用開始以来、10 数年以上もの間、年間 30 から 40 課題の共同利用に付されてきた。老朽 化が著しく装置トラブルによる利用停止が頻発してユーザーに多大の迷惑をかけていた。制御コンピューターも VAX と いう一昔前のものであり、保守パーツにも事欠くありさまであった。そこで平成 15 年度概算要求に 2 次元位置敏感型小 角中性子散乱装置(高性能化)を申請した。概算要求では装置の高性能化は認められなかったが、同じ年度の臨時経費で 装置の高性能化ができることとなった。そこで、長尾助手、中性子科学研究施設の技官の方々、そして博士課程に進んだ 岡部君を中心とするプロジェクトチームを立ち上げ、SANS-U の高性能化に着手した。その内容は、(1)制御系の全面的 改良(VAX システムから WINDOWS-LabVIEW システムへ)、(2)単心線 2 次元検出器から多心線 2 次元検出器への交 換、(3)真空飛行管内を含む配線系の全面交換、(4)ビームストップ、モニタカウント駆動系の改良、(5)測定中に円環 平均強度がリアルタイムで確認できる測定プログラムの完備(図 14)、などであった。これら一連の作業は、2002 年 11 月末の原子炉停止と同時に着手し、2003 年 5 月末には重要な変更を一通り終え、6 月からの共同利用にどうにか間に合わ せた。その後も改良は続き、制御系ソフトウエアの不具合を直したり、理研の清水裕彦博士(現 KEK 教授)グループの 援助を受けて集光系オプションを加えたりして、より使いやすく高性能な SANS マシンに変身させた。この一連の高性能 化については最近の論文にて詳しく紹介した⁽¹⁸⁾。また、岡部君はこの高度化の成果を日本中性子科学会第 3 回年会にて発 表し、ポスター賞を受賞したことも付け加えたい。

中性子スピンエコー装置は国内では唯一、かつ、世界的にも 10 台前後しかない戦略的な装置である。この装置 (ISSP-NSE) は 1990 年頃から広島大学の好村磁洋教授(現中央大教授)、武田隆義助教授(現広島大教授)グループに よって開発が進められていた。2003 年度の後半から 2004 年度にかけてガイドブランチからガイドエンドへの移設が行わ れ、同時に高度化が進められた。この移設を機に iNSE と名前を改め世界に伍する装置として稼動している。大きな改良 点は、(1) 中性子速度選別器の導入及びポラライザ、アナライザ更新による利用可能波長域の増大、(2) 測定可能散乱角 領域の増強、(3) 2 次元検出器設置による測定の効率化、(4) 移設によるビーム強度の増加、(5) 制御システムの更新な どである。これにより、ダイナミックレンジが波数及び時間領域でいずれも 1 桁以上拡大され、世界の標準的な NSE 装 置と同等のダイナミックレンジを持つに至った。中性子のスピン自由度を利用した、中性子非弾性散乱装置としては最高 のエネルギー分解能を持ち、カバーする時間空間領域が他のどんな方法と比較してもユニークである、と言う特徴から、 iNSE は中性子科学研究施設の主要研究装置として大きな期待が寄せられている。

10.その他の共同研究と産業界へのサービス

日本原子力研究所(現日本原子力開発研究機構)の委嘱でアジア原子力協力フォーラム(FNCA)の研究炉利用プログラムに参加した。参加国は、中国、インドネシア、日本、韓国、マレーシア、フィリピン、タイ、及びベトナムである。インドネシアへ2回、中国へ1回出張し、当事国の中性子散乱研究の支援を行った。その一つの成果として、フィリピンからLucille Abad さんが来日し、カラギーナンの放射線分解生成物の構造とゲル化の研究を行った。特に、100kGyのガンマ線を照射したカラギーナンのみ生物成長促進作用があることに興味をもち、その理由づけとなる研究を動的光散乱、中性子散乱などで行った。その他、ゲル、界面活性剤、汎用高分子材料などの研究で民間企業数社との共同研究や高校への出張講義などを通じて社会への知的情報還元を行っている。

11. 学会賞受賞とこれから

2005 年 3 月、神奈川大学で開催された日本化学会年会において日本化学会学術賞を受賞する栄誉に浴した。対象となった功績は「ゲルの構造不均一性とゲル化機構に関する研究」で、京都工芸繊維大学時代後半から物性研 5 年間の研究活動の結実である。両大学で研究を共にした 40 余名の学生とともに受賞を喜びたい。

2005年4月、新たに鈴木拓也君、宮崎翔君を迎えた。さらに、3月から秘書として活躍してもらっている宮崎京子さん を加えると総勢8名のにぎやかな研究室になった(図15)。着任の時を振り返ると隔世の感があり、よくここまで続けて 来られたなと感慨ひとしおである。長尾助手の助けを借り、狩野研究員や多くの学生、とりわけ岡部哲士君にはよく頑張 ってもらった。また、出張の多い私の留守中、SANS-Uの面倒を中心になってみてくれている渡辺聡技官、私流の研究ス タイルを認めてくださっている吉澤施設長にも心から感謝の意を表したい。

研究室紹介を書き終わっても冒頭で述べた最適化問題の解は一向に見つからないが、解き方のヒントは得たように思う。 自己採点としては及第点としよう。最後に研究室のモットー、Fusion of the Universality of Physics and the Particularity of Chemistry を掲げて、メンバーとともに研究、教育、共同利用推進に邁進したい。



図 15. 研究室メンバー (平成 17年 11月 14日撮影)

文献

- (1) S. Takata, T. Norisuye and M. Shibayama: Macromolecules 35 (2002) 4779.
- (2) T. Norisuye, N. Masui, Y. Kida, D. Ikuta, E. Kokufuta, S. Ito, S. Panyukov and M. Shibayama: Polymer 43 (2002) 5289.
- (3) S. Panykov and Y. Rabin: Physics Report 269 (1996) 1.
- (4) S. Okabe, S. Sugihara, S. Aoshima and M. Shibayama: Macromolecules 35 (2002) 8139.
- (5) 青島貞人、柴山充弘: パリティ 18 (2003) 24.
- (6) M. Shibayama, C. Fuse, and S. Okabe, S. Sugihara and S. Aoshima: in "Structure and Dynamics in Macromolecular Systems with Specific Interactions", K. Adachi and T. Sato Eds., pp. 101- 109 Osaka Univ. Press, Osaka (2005). C. Fuse, S. Okabe, S. Sugihara, S. Aoshima and M. Shibayama: Macromolecules **37** (2004) 7791.
- (7) M. Shibayama, T. Tanaka and C.C. Han: J. Chem. Phys. 97 (1992) 6829.
- (8) M. Shibayama, T. Tanaka and C.C. Han: J. Chem. Phys. 97 (1992) 6842.
- (9) M. Shibayama, K. Isono, S. Okabe, T. Karino and M. Nagao: Macromolecules 37, (2004) 2909.
- (10) N. Osaka and M. Shibayama: Phys. Rev. Lett. in press.
- (11) S. Okabe, K. Andoh, K. Hanabusa and M. Shibayama: J. Polym. Sci., Part B, Polym. Phys. Ed. 42 (2004) 1841.
- (12) P. Dastidar, S. Okabe, K. Nakano, K. Iida, M. Miyata, N. Thonai and M. Shibayama: Chem. Mater. 17 (2005) 741.
- (13) T. Karino, Y. Okumura, C. Zhao, T. Kataoka, K. Ito and M. Shibayama: Macromolecules 38 (2005) 6161.
- (14) M. Shibayama, T. Karino, S. Miyazaki, S. Okabe, T. Takehisa and K. Haraguchi: Macromolecules 38(2005)10772.
- (15) M. Nagao, H. Seto, M. Shibayama and N. L. Yamada: J. Appl. Crystallogr. 36 (2003) 602.
- (16) M. Nagao, H. Seto, D. Ihara, M. Shibayama and T. Takeda: J. Chem. Phys. 123 (2005) 054705.
- (17) M. Shibayama, M. Nagao, S. Okabe and T. Karino: J. Phys. Soc. Jpn., 74 (2005) 2728.
- (18) S. Okabe, M. Nagao, T. Karino, S. Watanabe, T. Adachi, H. Shimizu and M. Shibayama: J. Appl. Crystallogr. 38 (2005) 1035.

物性研究所短期研究会

固体における水素の科学

日時:2005年11月24日-25日

場所:東京大学物性研究所6階大講義室

福谷克之 東京大学生産技術研究所 青木勝敏 日本原子力研究開発機構 池田 進 高エネルギー加速器研究機構 久保田実 東京大学物性研究所 杉本秀彦 中央大学理工学部 常行真司 東京大学大学院理学系研究科 吉信 淳 東京大学物性研究所

提案者

水素は原子核の質量が小さいため、固体およびその表面で大きな振動エネルギーと波動関数の広がりをもち、トンネル 効果をはじめとしてさまざまな量子効果を示す。また原子サイズが小さいために、水素は固体中に容易に侵入し、しばし ば固体の構造や物性を大きく変化させる。応用に目を向けても、二酸化炭素を排出しないクリーンなエネルギー源として 注目を集めている。

これまで固体における水素に関する研究は、金属、半導体、誘電体、あるいは、表面・界面、固体水素や高圧物性、低 温物性など、個別の分野で進められてきた。近年、実験手法と計算方法の開発が進むにつれて、固体における水素の存在 状態や輸送現象・反応性、水素と物性との相関についての理解が深まり、それと同時に、個別に進められてきた研究分野 間の共通点が認識されるようになってきた。また、ポジトロンやミュオン、反水素など水素の同位体ともいうべき粒子を 用いた研究も大きな広がりを見せ、境界領域として新しい展開を見せつつある。このような背景に鑑み、本短期研究会は、 固体と水素をキーワードに、多岐分野にわたる研究者が一堂に会して討論を行い、固体-水素系の抱える問題点を明確にす るとともに、異分野間の情報交換と交流を行うことを目指して開催した。ロ頭発表 20 件に加え、懇親会を兼ねたポスタ ーセッションを設け、ポスター発表者には、1 分間のショートプレゼンテーションをしてもらうことで研究者間の交流に 努めたつもりである。参加者は当初の予定を上回り2日間で延べ180名を超え、活発な研究会となった。以下に、プログ ラムと講演要旨を掲載する。

※口頭発表及びポスター発表の要旨は、<u>http://bilbo.phys.s.u-tokyo.ac.jp/hydrogen/</u>にも掲載されています。

プログラム

- 13:00-13:05 開会の挨拶 福谷 克之 (東大生産研)
- 13:05-13:30 鹿内 文仁(高エネ研)
- 「水素結合型誘電体の中性子によるプロトン伝導解析」

13:30-13:55 上村 洸(東京理科大)

「水素結合物質におけるプロトン誘起による超イオン伝導機構と強弾性」

13:55-14:20 八木 駿郎(北大電子研)

「水素結合型誘電体のラマン散乱」

14:20-14:45 清水 克哉(阪大極限科学研究センター)

「固体水素の高圧実験」

14:45-15:10 長柄 一誠(阪大基礎工) 「固体水素の理論の現状」

- 15:10-15:30 **coffee break**
- 15:30-15:55 新倉 弘倫(カナダ国立研究機構・科学技術振興機構さきがけ) 「アト秒精度での重水素分子振動波束の測定と制御」

15:55-16:20 立川 仁典(横浜市大・JST さきがけ)

「水素系の量子シミュレーション」 16:20-16:45 山崎 敏光(理研) 「反陽子ヘリウム原子分子の低温における水素分子との化学反応」 16:45-17:10 秋葉 悦男(産総研) 「水素貯蔵材料の現状と将来」 17:10-17:35 岩村 康弘(三菱重工)

「重水素透過による Pd 多層膜上での元素変換」

17:35-20:00

Poster 1min presentation (6 階大講義室) [懇親会] + **Poster Session** (6 階ラウンジ)

■11月25日(金)

- 9:30-9:55 並木 章(九州工業大学) 「シリコン表面と水素原子の反応キネティクス」 9:55-10:20 加藤 浩之(理研)
- 「Si(001)表面での水分子反応における水素結合ネットワークの役割」 10:20-10:45 原田 晶子(広島大学生物圏科学研究科)
- 「ナノ構造化グラファイトにおける水素放出の第一原理シミュレーション」
- 10:45-10:55 **coffee break**
- 10:55-11:20 香内 晃(北大・低温研)

「アモルファス氷表面における CO と水素原子の反応」

- 11:20-11:45 関谷 博(九州大)
- 「水素結合二量体における複合的トンネル効果」 11:45-12:10 松崎 禎市郎(理研) 「トリチウム固体中の蓄積³He への負ミュオン移行率の温度依存性」
- 12:10-13:10 **lunch**
- 13:10-13:35 下村 浩一郎(高エネ研) 「ワイドギャップ半導体の n 型電気伝導性起源についての μSR 法による研究」
 13:35-14:00 久保田 実(物性研) 「有限温度領域での超流動と PdH(D)x 系の水素状態相図」
 14:00-14:25 山川 浩二(愛媛大工) 「Pd-H(D)合金の電気抵抗変化」
 14:25-14:50 青木 勝敏(原研) 「希土類金属水素化物の電子転移」
 14:50-13:20 深井 有(中央大)
 - 「まとめ」

ポスター発表

- **P01** 館山 佳尚、J. Blumberger、M. Sprik、大野 隆央(物材機構、ペンシルバニア大学、ケンブリッジ大学) 「新規第一原理計算手法による水溶液中の酸化還元反応解析」
- **P02** 石井 洋典、柴山 義行、白浜 圭也 (慶応大理工) 「ナノ多孔質ガラスに閉じ込められた過冷却水素の固化圧力測定」

- **P03** ストラッサー パトリック (KEK 物構研) 「Muon Transfer Reaction Studies in Solid Hydrogen and Deuterium Films with Argon Ions Implanted Non-Uniformly」
- **P04** 林 愛子 ¹、志賀 基之 ^{2,1}、立川 仁典 ^{1,3} (¹横浜市大院、²原研、³JST PRESTO) 「Ab initio 経路積分法による二水素結合クラスターおよびその同位体効果の解析」
- **P05** 山脇 浩、藤久 裕司、竹谷 敏、坂下 真実、千勝 雅之、本田 一匡(産総研 計測フロンティア研究部門) 「高圧下における固体酸 CsHSO4 のプロトン伝導と構造」
- **P06** 刈谷 奏¹、牛田 考洋¹、北野 利明¹、熊田 高之²、熊谷 純¹(¹名大院工、²原子力開発機構基礎セ) 「4.2 Kγ線照射固体パラ水素中 H₂+コアクラスターの減衰挙動及びその機構」
- **P07** 熊谷 純¹、刈谷 奏¹、稲垣 宏樹¹、北野 利明¹、熊田 高之²(¹名大院工、²原子力開発機構基礎セ) 「照射固体パラ水素中に生成する H₂⁺(H₂)_n(o-D₂)_{2.n}(n = 0, 1, 2)の ESR 観測とその解析」
- **P08** 広田 幸二¹、大石 陽次郎²、金沢 育三³、福谷 克之⁴、野沢 清和⁵、小森 文夫⁶ (^{1,2,3} 東学大物理、⁴ 東大生研、^{5,6} 東大物性研) 「低速陽電子ビームによる Ni(111)水素吸着層の研究」
- **P09** 北 幸海 1、前園 涼 2.3、立川 仁典 1.3 (1横市大総合理学研究科、2物質・材料研究機構、3JST さきがけ) 「多成分量子モンテカルロ法による陽電子化合物の理論的解析」
- **P10** 宇田川 太郎¹、立川 仁典^{1,2} (1横市大院理、²JST-さきがけ) 「核・電子の量子効果を考慮した多成分密度汎関数理論(MC_DFT)の開発」
- **P11** 今井 彰夫¹、原田 修治²、Andriy Penzev³、久保田 実³(¹新潟大自、²新潟大工属、³東大物性研) 「低温度領域下におけるパラジウム中の水素の動的振舞い; 捻じれ振り子実験から」
- **P12** 西山 樟生¹、下村 浩一郎¹、西山 純江¹、髭本 亘²、久保 謙哉³(¹高エ研、²原研、³ICU) 「2次元水素結合系四角酸中のμSR」
- P13 赤木 和人 ¹、加藤 浩之 ²、川合 真紀 ²、常行 真司 ¹(¹東大院理、²理研) 「Si(001)表面における水分子の解離反応および H/D 交換反応:水素結合形成による反応性変化の理論計算による検討」
- **P14** 中西 寛⁻¹、笠井 秀明⁻¹、福谷 克之⁻²、岡田 美智雄⁻³(¹阪大院工、²東大生研、³阪大院理) 「Ir(111)上の吸着水素原子間の相互作用」
- **P15** 尾澤 伸樹、Tanglaw Roman、中西 寛、笠井 秀明(阪大院工) 「Cu(100)及び Cu(110)表面における水素原子の量子状態」
- P16 余語 覚文 A、西内 満美子 A、福見 敦 A,B、黎 忠 A,B、小倉 浩一 A、織茂 聡 A、加道 雅孝 A、匂坂 明人 A、林由 紀雄 A、森 道昭 A、A. PorozhkovA、大道 博行 A、中村 衆 A,C、岩下 芳久 C、野田 章 C、大石 祐嗣 D、名雪 琢弥 D、藤井 隆 D、根本 孝七 D (日本原子力研究開発機構、関西光科学研究所、A 放射線医学総合研究所、B 京都大学化学研究所、C 電力中央研究所 D) 「超短パルス高強度レーザーによる固体薄膜からの高速プロトン発生」
- **P17** 福田 宗行^{1,2}、久保田 実¹(¹東大物性研、²現日立中研) 「ガラス基板上 He の「不活性原子膜」の精密捻り振子実験による 2 次元相図」
- P18 佐久間 怜、常行 真司(東大院理)
 「新しい第一原理計算手法による固体水素バンドギャップの圧力変化」
 P19 鈴木 涼、Markus Wilde、松本 益明、福谷 克之(東大生研)
- 「Y単結晶薄膜の水素化における結晶成長温度依存性」
- **P20** 荒木 秀明¹、坂牧 由梨¹、原田 修治²、久保田 実³(¹長岡高専、²新潟大工、³東大物性研) 「電気抵抗率で見た高濃度パラジウム-水素系の低温異常」
- **P21** 藤原 理悟、二木 かおり、河内 泰三、福谷 克之、岡野 達雄(東大生研) 「Cr₂O₃のオルソ-パラ転換と磁場効果解明に向けたレーザー共鳴誘起蛍光法の開発」
- P22 二木 かおり、藤原 理悟、松本 益明、福谷 克之、岡野 達雄(東大生研) 「磁性不純物を含む Ag 表面でのオルソ・パラ転換機構の解明と純オルソ水素生成装置の作成」
- **P23** 松本 益明¹、小倉 正平¹、福谷 克之¹、岡野 達雄¹、岡田 美智雄² (¹東大生研、²阪大院理) 「低速電子回折法の動力学的解析による Ir(111)清浄表面および水素吸着表面構造の研究」
- **P24** 紅谷 篤史¹、山本 達^{1,2}、向井 孝三¹、山下 良之¹、吉信 淳¹(¹東大物性研、²現スタンフォード放射光施設) 「Rh(111)における第一層水分子のエネルギー・キネティクス・微視的状態」
- P25 田中 誠二、鈴木 涼、Markus Wilde、福谷 克之、岡野 達雄(東大生研) 「Y 水素化物の金属-半導体転移機構の解明~赤外吸収分光装置の開発~」

水素結合型誘電体の中性子によるプロトン伝導解析

Neutron Powder Diffraction Study on Hydrogen-bonded Protonic Conductor

鹿内 文仁¹、鬼柳 亮嗣²、富安 啓輔¹、米村 雅雄³、岩瀬 謙二¹、Dyah Sulistyanintyas¹、
 Tuerxun Wuernisha¹、森 一広⁴、石垣 徹⁵、筑紫 格⁶、池田 進¹、神山 崇¹
 ¹高エネ研、² IPNS、³茨大院理工、⁴KUR、⁵JAEA、⁶千葉工大工

化学式が M₃X (YO₄)₂ (M=K, Rb, Cs, X=H, D, Y=S, Se)で表される物質の多くは室温以上で相転移し、室温と比較して 2~3 桁高い電気伝導度を示す。電気伝導度の変化はプロトンの移動によると考えられており、近年、燃料電池の固体電解 質として工業的に注目されると共に固体内のプロトン移動現象として科学的な観点からも脚光を浴びている。これらの物 質の結晶構造は 2 つの YO₄ 四面体と 1 つの水素(重水素)が水素結合によって YO₄-X-YO₄ ダイマーを形成しており、ダ イマー同士の間には水素結合が存在しない。また、ダイマーは単斜晶の *ab* 面に平行に整列しておりレイヤーを形成して いる。伝導性の変化を説明するモデルとして、高温相においてダイマー内の水素結合が切れ、隣接する 3 つの等価な YO₄ 四面体の1 つと水素結合を再形成することを繰り返すことでレイヤー内をプロトンが移動するモデルが考えられている。

我々は K₃H(SeO₄)₂の相転移およびプロトン伝導のメカニズムを明らかにする目的で温度 298 K, 413 K において粉末 中性子回折実験を行い結晶構造の変化を調べた。また、マキシマムエントロピー法(MEM)によりそれぞれの温度での プロトンの密度分布を求めた。室温において水素結合距離(O-O 間)2.522(2)Åでダイマーを形成していた SeO₄四面体は 413 K において隣接する 3 つの SeO₄四面体と等確率で水素結合しており、水素結合距離は 2.595(9) Åであった。また、 ダイマー間の O-O 間距離も 295 K での原子間距離と良く一致しており、短時間または局所構造としては室温相の構造を とっていることが明らかとなった。MEM 解析の結果、1 つの水素結合あたりのプロトンの密度は 298 K では約 87 % が 水素結合内に集中しているのに対し、413 K では約 21 % に低下してた。また、413 K ではレイヤー間においても約 13 % のプロトン密度が得られた。298 K に対するプロトン密度の増減はよく一致しており、高温相でのフレンケル欠陥の存在 が示唆される。

Oral 11/24 PM02

水素結合型物質におけるプロトン誘起による超イオン伝導機構と強弾性

Mechanism of Proton-induced Superionic Conduction in Hydrogen-Bonded Materials and Ferroelasticity

<u>上村</u>洗、池畑 誠一郎、松尾 康光、羽取 純子 (東京理科大・理学部・応用物理)

Abstract

Hydrogen-bonded materials, whose nature is closely related to the behavior of protons in hydrogen-bonds, exhibit a number of interesting phenomena. From this standpoint considerable attention has recently been paid to the role of protons in ionic conduction in various hydrogen-bonded systems. In this context we have recently been working on the superionic conduction in $M_3H(XO_4)_2$ [M=K, Rb, Cs and X=S, Se] type dielectric crystals. These materials exhibit a ferroelastic phase transition at high temperature such as 400K, and an anomalously large increase of electrical conductivity of a single crystal has been observed near the phase transition temperature Tc. Further, above Tc ionic conductivity is very high along a layer plane so that these materials are called superionic conductors. In this talk the mechanism of superionic conduction just below and above Tc is discussed, based on our recent theoretical and experimental results. In the first part of the talk the key features of the conduction mechanism in the high temperature "superionic" phase are clarified. Those are; (1) two kinds of ionic states, H₂XO₄^(+e) and XO₄^(-e) are formed thermally by breaking of the hydrogen-bonds; (2) $H_2XO_4^{(+e)}$ and $XO_4^{(-e)}$ ionic states move coherently from an XO_4 tetrahedron to a distant XO₄ as the result of successive proton tunneling among the hydrogen bonds. Calculated mobility is 10 to 100 times larger than that of the nearest neighbor hopping, and thus calculated conductivity is very high of the order of $10^{-2}\Omega^{-1}$ cm⁻¹ at Tc, consistent with experimental results. In the second part of the talk the mechanism of conduction below and at the phase transition Tc is discussed. Just below Tc, it is suggested that by the precursor effect of the phase transition, the ferroelasic phase consists of the mixture of superionic regions in which the distances between XO₄ tetrahedrons are the same and of the insulating regions in which XO₄'s form XO₄-H-XO₄ dimers by hydrogen-bonds. As a result the superionic region contributes to the ionic conductivity for T<Tc and the propagation of superionic regions along the electric field leads to the (Tc-T)^{-1/2} power law in the temperature dependence of conductivity just below Tc. From the present result we will suggest that the occurrence of the

ferroelastic phase is due to the competition between the decrease of kinetic energy by the successive proton tunneling and the increase of elastic energy by the deformation of hydrogen bonds.

References related to the present work:

T. Ito and H. Kamimura, J. Phys. Soc. Jpn. 67 (1998) 1999-2007

H. Kamimura and S. Watanabe, Phil. Mag. 81 (2001) 1011-1019

H. Kamimura, Y. Matsuo, S. Ikehata, T. Ito, M. Komukae, and T. Osaka, physica, status solidi 241, 61-68 (2004)

Y. Matsuo, J. Hatori, Y. Nakashima, S. Ikehaa, Sol.St. Commun. 130, 269 (2004)

Y. Matsuo, J. Hatori, Y. Yoshida, K. Saito, S. Ikehata, Solid St. Ionics 176, 2461 (2005)

Oral 11/24 PM03

水素結合型誘電体のラマン散乱

八木 駿郎¹、笠原 勝¹、ポー・カウン²、島 徹³ ¹北大電子研、²ヤンゴン大(ミャンマー)、³富士通

固体の物性に果たす水素の役割を明らかにす るためには、水素結合個々の性質を解明するば かりでなく、水素結合間の相互作用を明らかに することが重要である。また、多くの誘電体結 晶は無色透明で可視光において吸収が無く、レ ーザー光を用いたラマン散乱等により物質中の 格子振動あるいは分子振動のダイナミクスを精 度良く観測できる。このことを利用して、本研 究では、水素結合ネットワークを持たない孤立 型水素結合誘電体 K₃H(SO₄)₂ およびその水素 H を一部重水素 D で置換した混晶 K₃D_xH_{1-x}(SO₄)₂ (x=0~1) のラマン散乱スペ クトルを観測し、H結合とD結合の間の水素結 合間相互作用を調べた。その結果、水素結合に 直接結びつく HSO4 イオンの運動を示すv2ス ペクトルが、Dの濃度 x に顕著に依存すること が明らかになった。すなわち、図1に示すよう に HSO4 イオンの内部振動は、DSO4 イオンや SO4イオンのものに比べて、顕著なx依存性を 示す。また、図2に示すように、それらの温度 依存性にも特異な差が現れた。更に、スペクト ル幅から得られる、HあるいはDの運動の特性 時間の異常増大の温度依存性にも顕著な差が観 測された。これらの結果より、H 結合はD 結合 より"soft"であると結論された。



【参考文献】

1) P. Kaung, M. Kasahara and T. Yagi: J. Phys. Soc. Jpn. 65(1996)1114.

2) T. Shima, M. Kasahara, P. Kaung and T.Yagi:J.phys.Soc.Jpn.65(1996)1102.

Oral 11/24 PM04

固体水素の高圧実験

Experiments in Solid Hydrogen under High Pressures

清水 克哉 大阪大学極限科学研究センター

もっとも単純で基本的な元素である水素が示す物性は、多様な物質が示す現象・機能の根本的理解に我々を導いてくれ るはずである。しかし未だにその高密度状態-高々地球の中心圧力程度-にあるとされる金属状態の検出はもとより、信 頼できる実験データの蓄積も不十分であり、現在の高圧研究者にとって金属水素の実現は究極のターゲットのひとつであ るといえる。

水素の金属化はWignerらによって当時では未踏の超高圧力であった 25GPa(1GPaは約1万気圧)で起こると予測さ れた[1]。しかしその後実験技術が進歩し、その予測値が低すぎたことが明らかになってきた。超高圧力の発生にはダイヤ モンドを使ったダイヤモンドアンビルセル(DAC)が用いられる。近年 DAC によって高圧研究を先導してきた米国カー ネギー研究所の Mao らによって、水素の金属化の兆候を伝える論文が発表された。圧力測定用のルビー粉末の隙間に黒 色化した水素が見えるというものである[2]。この結果に対しては実験上の問題などを指摘して異論も唱えられたが未だ結 論は出ていない。最近の報告でも 320GPa において赤みを帯びた水素の写真とともに金属化の兆候が示され、金属化圧は 約450GPa と予測されている[5]。

一方、ガス銃を用いた動的圧縮によっては高温高圧の水素の金属流体が得られている[3]。これによると150GPa、2000 Kには液体ではあるものの金属状態とされ、木星などの巨惑星の内部構造の解明に寄与したとされる。しかしDACによる静的実験とのクロスチェックはまだなされていない。水素が超高圧状態では低温度においても液体状態をとる可能性が示唆され、またその金属については超流動または超伝導状態であるとの理論予測が最近発表された[4]。ますます静的実験による金属水素の詳細な物性測定の実現が待たれる状態にあるといえる。しかし450GPaは現在のところ到達が極めて困難とされる圧力値であり、何らかの実験的なブレークスルーが必要であろう。講演では上記の固体水素の金属相の探索実験を紹介したうえで、我々が進めている電気抵抗測定による金属水素の直接検証に向けた開発研究の状況も紹介したい。

[1] Wigner, E. & Huntington, H. B., J. Chem. Phys. 3 (1935) 764.

[2] Mao, H. K. & Hemley, R. J., Science 244 (1989) 1462.

[3] Weir, S. J. *et al.*, Phys. Rev. Lett. **76** (1996) 1860.

[4] Babaev, E. et al., Nature 431 (2004) 666.

[5] Loubeyre, P. et al., Nature 416 (2002) 613.

Oral 11/24 PM05

固体水素の理論の現状

長柄 一誠 (阪大基礎工)、長尾 和多加 (東北大通研)、竹沢 智樹 (舞鶴高専)

水素はこの宇宙の最も多い構成物質である。数にして総原子数の90%、質量にして4分の3を占ると考えられている。 水素(H)原子は原子核を構成するプロトン1個と電子1個で出来ている。同位体には原子核に中性子が1個加わった重水 素(D)、2個加わった3重水素(T)があるが、3重水素は自然界にはほとんど存在しない。次世代エネルギーとしての核融 合はD-T反応を利用するが、燃料のDは海水中にあり、またTはLiの反応から作られる。(海水中にLiは十分存在して いる。)同位体質量が2倍、3倍の元素は他にはない。水素は常温、常圧では原子が2個くっついて水素分子を形成し、気 体である。水素分子は同種の粒子としてのプロトンの統計性からオルソ水素とパラ水素が存在する。温度を下げると 20.38Kで液体になり、13.92Kで水素分子の固体が出来る。この固体水素の融点は圧力をかけると急に上昇し、5万気圧 では常温を超える。5万気圧以上かかったダイヤモンドアンビル・セルの中では常温で固体である。

常圧での固体水素は4重極ガラスの問題、オルソーパラ混晶の問題等を除いて研究は終焉に近づいているといえるかも知れない。圧力下での固体水素は最初宇宙物理の分野で巨大惑星に関する興味から研究が行われていた。80年代に入り高圧技術の発達と共に地上での実験が可能になり、理論、実験ともに実に多くの研究者が、圧力下での物性を予測あるいは解明すべく挑戦し、その挑戦は現在でも続いている。しかし解明はまだ殆どされていないと言っても良い。

ウイグナーとハンティントンによる金属水素の予言は多くの研究者の興味を引いた。超高圧下の水素分子固体では一つ の原子から見て、分子内の相手の原子までの距離と隣の分子に属する水素原子までの距離の差は殆ど無くなり、従って分 子を形成している理由がなくなり分子解離をして、アルカリ金属と同じように半分満ちたバンドを作り金属化するという ものであった。それから 70 年の月日が過ぎたがまだ我々は金属になった水素を見ていない。後に分子結晶のままでの金 属化の可能性も予言されているが、爆縮によりルビジュウームに近い電気抵抗値を観測したという報告を除いて、静的な 圧縮により金属化を観測したという報告は確実なものがまだない。

しかし最近の実験技術の向上、計算機性能の向上に伴う大規模計算は圧縮水素に対して着実にその包囲網を狭めている。 最近の圧縮固体水素の実験をふまえながら、何が水素の理論的研究を難しくしているのか、どのような手法で理論的研究 が行われているのか、現在理論はどこまで圧縮固体水素の物性にせまっているのか、そして残されている多くの課題につ いて報告する。

Reference:

- 1) I. Goncharenco and P. Loubeyre, Nature 435, 1206 (2005).
- 2) P. Loubeyre, F. Occelli, and R. LeToullec, Nature **416**, 613 (2002).
- 3) S. A. Bonev, E. Schwegler, T. Ogitsu, and G. Galli, Nature 431 (2004).
- 4) C. Pierleoni, D. M. Ceperley, and M. Holzmann, Phys. Rev. Lett. 93, 146402-1(2004).
- 5) H. Kitamura, S. Tsuneyuki, T. Ogitsu, and T. Miyake, Nature 404, 259 (2000).

アト秒精度での水素分子振動波束の測定と制御

Vibrational wave packet dynamics of D2+ with attosecond time resolution

新倉 弘倫

カナダ国立研究機構/科学技術振興機構さきがけ

強いレーザー電場を分子に照射すると、内部の電子波動関数の一部がトンネルイオン化し、連続状態に放出される。この電子波束は、レーザーの一周期以内に電場によって揺り戻され元の分子と再衝突する。この再衝突過程を利用して、分子の振動運動や分子軌道、および分子内電子波束の時間発展等をアト秒の精度で測定することが出来る。本研究では、重水素分子イオンの振動運動を 1.7fs-4.5fs の時間領域で 200 アト秒・0.05 オングストロームの時間分解能で測定した。また、8fs のレーザーパルスを用いて重水素分子イオンの振動波動関数の時間発展を、0~70fs の時間領域で 2fs の時間分解 能で測定した。さらに、振動波束が進むに従ってポテンシャル曲面をレーザー電場で歪めることで、重水素分子イオンの 解離過程を制御し、分子結合の切断に伴う振動波動関数の時間発展を実時間で測定した。

Oral 11/24 PM07

水素系の量子シミュレーション

Quantum simulation for hydrogen systems

立川 仁典^{1,2}、石橋 宏章¹、林 愛子¹、志賀 基之^{3,1} ¹横浜市立大学大学院国際総合科学研究科、²JST さきがけ、³日本原子力研究開発機構

水素結合系やプロトン(水素)移動反応など、多くの化学反応過程において原子核の量子力学的性質が重要であることが見出されるようになった。我々は電子核混合系を量子力学的に取り扱うために、分子軌道の概念を多成分系に拡張させた「多成分(multi-component)分子軌道法」の開発^[1]、および断熱近似のもとで核の量子効果に経路積分法を、電子状態に非経験的分子軌道法を用いる「第一原理経路積分分子動力学(*ab initio* PIMD)法」の開発^[2]を行ってきた。本報告では、

水溶液中での H⁺, OH⁻移動で重要な役割を果たすと言われてい る H₅O₂⁺, H₃O₂^{-[3][4]}に対し、*ab* initio PIMD 法による核の量子 効果を含めた計算結果を示し、核の量子効果が及ぼす骨格構造変 化、電子状態緩和、さらに H/D 同位体効果を中心に考察する。

図1に(a)H₅O₂+, (b)D₅O₂+ における、酸素間距離(R₀₀)および 二つの OH 距離の差(*る*RoH*)に関する二次元分布を示す。ポテンシ ャルの評価には、MP2/6-31++g**を用いた。従来の第一原理計算 でH₅O₂+を計算すると、酸素原子間の中心に水素原子が位置した 構造が最も安定となった。原子核を量子力学的に扱った結果を見 ると、H₅O₂+における水素結合プロトン(図 1(a))は、D₅O₂+(図 1(b))に比べてより大きく広がっているのがわかる。また H₅O₂+ の R₀₀ 期待値は、D₅O₂+の R₀₀ 期待値よりも長くなった。これ は単一井戸ポテンシャルにおける、OH 方向の非調和性に由来す るものである。図 1(c), (d)に H₃O₂-と D₃O₂-の結果を示す。平衡 構造では、酸素間の水素原子は片方の酸素原子に偏った構造が最 安定となった。重水素化した D₃O₂-でも、同様に、水素原子が片 方の酸素原子に偏った分布が得られた(図 1(d))。一方 H₃O₂-で は、酸素原子間の中心付近になだらかなピークが現れ(図1(c))、 古典的な安定構造とは異なった分布を示した。また D₃O₂-の R₀₀ 期待値は、 $H_3O_2^-$ の R_{00} 期待値よりも長くなった。これは重水素 化により水素結合距離が長くなるといった Ubbelohde 効果に対 応する。



Figure 1. Two dimensional distribution of $(\mathbf{R}_{00}, \delta \mathbf{R}_{OH(D)^*})$ for (a) H₅O₂⁺, (b) D₅O₂⁺, (c)H₃O₂⁻, and (d) D₃O₂⁻. The peak positions (**R**OO, $\delta \mathbf{R}_{OH(D)^*}$) are around (2.42, 0.00) and (2.41, 0.00) for (a) H₅O₂⁺ and (b) D₅O₂⁺, while around (2.47, 0.00) and (2.48, ±0.15) for (c) H₃O₂⁻, and (d) D₃O₂⁻, respectively.

当日は、等電子系である N₂H₇+, N₂H₅-の結果も報告する。

- M. Tachikawa, Chem. Phys. Lett. 360, 494 (2002). M. F. Shibl, M. Tachikawa, O. Kuhn, Phys. Chem. Chem. Phys. 7, 1368 (2005).
- [2] M. Shiga, M. Tachikawa, and S. Miura, J. Chem. Phys. 115, 9149 (2001). M. Tachikawa and M. Shiga, J. Chem. Phys. 121, 5985 (2004).
- [3] M. E. Tuckerman, D. Marx, M. L. Klein, and M. Parrinello, Science, 275, 817 (1997).
- [4] M. Tachikawa and M. Shiga, J. Am. Chem. Soc. (Communication), 127, 11908-11909 (2005).

反陽子へリウム原子分子の低温における水素分子との化学反応

Chemical Reactions of Antiprotonic Helium Atomolecule with Hydrogenic Molecules at Low Temperatures

山崎 敏光 理化学研究所、東京大学大学院理学系研究科、

反陽子ヘリウム原子分子は、1991年に日本で発見された[1] 異常な長寿命原子で、それ以後、CERNの低エネルギー反 陽子蓄積リングからのビームを使い、そのレーザー分光が発展した[2]。これは、ヘリウム原子の電子の一つが反陽子に置 き換わったもので、反陽子は極めて大きな主量子数、角運動量(n,l)~(39,38)を持つため、ゆっくりと運動している。図に 示すように、そのような状態での反陽子は原子状態にあるばかりでなく、ヘリウム原子核と「二原子分子」的センターを つくる。このような「原子分子」は化学的に見ると"さまざまな内部構造の「核」を持つ水素原子"と見なせる。この"奇 妙な水素"の水素分子などとの化学反応が、レーザー分光の方法により各状態を見分けて観測されるようになった[3]。特 に、興味あるのは、反応にエネルギー障壁のある状態は高温でアーレニウス型の温度依存性を示すが、50度以下では一定 値になる、という量子トンネル効果があらわになる。一方、障壁を持たない状態は温度が下がるにつれて反応断面積が増 加する傾向が見られる。ウィグナーの閾則との関係が議論されている。



[1] M. Iwasaki et al., Phys. Rev. Lett. 67 (1991) 1246,

- [2] T. Yamazaki et al., Nature 361 (1993) 238; T. Yamazaki et al., Phys. Rep. 366 (2002) 183.
- [3] T. Yamazaki et al., Chem. Phys. Lett. 265 (1997) 137; B. Ketzer et al., Phys. Rev. Lett. 78 (1997) 1671; B. Juhasz et al., Chem Phys. Lett. 379 (2003) 91; to be published.

Oral 11/24 PM09

水素貯蔵材料の現状と将来

Hydrogen Storage Materials

秋葉 悦男 産総研

燃料電池および水素エネルギーが注目を集めるようになって間もなく十年が経過しようとしている。水素エネルギーは クリーンな燃料であると一般には理解されているが、それは皮相的な見方に過ぎない。水素は様々な種類の一次エネルギ ー(エネルギー資源)から製造することが可能な二次エネルギー(エネルギー媒体)である。二次エネルギーは大別する と電力と燃料になるが、水素は唯一、電力と相互変換可能な燃料である。燃料である水素は貯蔵が可能であることが電力 に無い利点である。しかし、ガソリンのような化石資源由来の液体燃料に比べて、水素は常温では気体であるためエネル ギーの体積密度がほぼ3桁小さい。そのため、水素を現在の燃料と遜色ない体積密度で貯蔵輸送する技術の開発が、水素 エネルギー経済を成立させるためには必要不可欠であると認識されている。

水素貯蔵材料なかでも、合金系材料(水素吸蔵合金)では水素吸蔵前の結晶構造と吸蔵後の水素化物の構造が水素吸蔵

特性の多くを決めていると言っても過言ではない。具体的には水素吸蔵量と水素平衡圧力がその中でも重要な特性である。 中性子回折法は、水素を含めた結晶構造解析のほぼ唯一の方法である。本講演では、当グループで行ってきた中性子回折 および中性子散乱をもちいた水素吸蔵合金の結晶構造解析の結果を紹介すると共に、最近、水素との相互作用が注目され ている欠陥と水素貯蔵材料の関係に関しても触れることとしたい。



図 BCC 構造を持つ Ti-V-Mn 合金の一水素化物 (H/M=1) と二水素化物 (H/M=2)の結晶構造 (大きな丸が金属原子 (Ti, V, Mn がランダムに固溶)、小さな丸が水素原子)

Oral 11/24 PM10

重水素透過による Pd 多層膜上での元素変換

Elemental Transmutation induced by Deuterium Permeation through Multilayer Pd Complex

岩村 康弘¹、伊藤 岳彦¹、坂野 充¹、山崎 紀子¹、寺田 靖子²、栗林 志頭真¹、石川 哲也³、笠木 治郎太⁴ ¹三菱重工業㈱ 先進技術研究センター、²高輝度光科学研究センター、 ³理化学研究所播磨研究、⁴東北大学原子核理学研究施設

CaO と Pd の混合層を有する Pd 多層膜に重水素を透過させた場合の Pd 多層膜表面での元素変化を観測した。Cs を Pd 多層膜に添加した試料を真空容器内に設置し、Cs を添加した面に重水素ガス、その反対の面を真空状態にすると、重水素 ガスが Pd 多層膜表面で解離し、Pd 多層膜中を重水素が透過していく。この際、真空容器内に取り付けた XPS で Pd 多層 膜の表面を経時的に観測すると、重水素の透過と共に Cs が減少し、代わりに Pr が出現してくる⁽¹⁾。Pd は 25mm X25mmX0.1mm のサイズで、温度は 70℃程度、重水素ガスの圧力は1気圧である。重水素ガスの代わりに軽水素ガスを 用いた場合や、Pd 膜の CaO と Pd の混合層が無い場合には、Cs の減少・Pr の出現が共に観測されない。また、深さ方 向分布計測の結果から、変換現象は表面から 10nm 程度の非常に薄い領域でおきている可能性が高い。

この現象をさらに検証・確証するため、SPring-8の BL37XU ラインに透過実験装置を持ち込み、XRF によって現象を 観測している。現在までの所、透過前に存在しなかった Prが重水素透過後に検出されている。また、SPring-8 での実験 によって生成物 Pr は均一に存在しているのではなく、空間分布があることや、従来検出されていなかった Pr 以外に La あるいは Ba と考えられるピークの存在などが明らかになってきている。現在、表面組織と生成物の分布に相関があるか どうかについて検討を行っており、今後生成物の時間変化や空間分布についてさらに検討していく予定である。

また、この変換現象は Cs に限ったものではなく、Sr や Ba を添加した際にも観測されている。これまでに全く同様な 方法で Cs の代わりに Sr を添加した場合には、重水素を透過させるにつれて Sr が減少し、Mo が出現してくる。この Mo の同位体比を SIMS で分析したところ、天然の Mo とは異なる同位体比を持っていた。Ba を添加した場合には Sm が観 測され、SIMS で分析すると ¹⁵⁰Sm が最も多かった。Ba は質量数 138 が最も多いため、質量数 137 を濃縮した Ba を添 加して透過で実験を行った所、SIMS で 149 の質量数が最も大きいことが判明した。

[文献]

(1) Y. Iwamura, M. Sakano and T. Itoh, Jpn. J. Appl. Phys. 41 (2002), pp. 4642-4648.

Oral 11/25 AM01

シリコン表面と水素原子の反応キネティクス

Kinetics study of D abstraction by H on Si surfaces

並木 章、稲永 征司、A. F. Khan、竹尾 明 九工大

シリコン表面に吸着した水素原子は気相水素原子により引き抜かれ、H2分子として脱離する。この反応は、アモルファ スシリコン薄膜のプラズマ CVD においてその表面反応を制御する上でとりわけ重要である。気相原子と表面原子を識別 する為に、吸着水素Hを重水素 D で置き換える。

引き抜き反応のタイプには、直接引き抜き反応(abstraction: ABS)と間接引き抜き反応(adsorption-induced-desorption: AID)9の2種類の反応タイプが存在する、

H (g)	+	$D(ad) \rightarrow$	HD(g)	:	ABS
H (g)	+	$D(ad) \rightarrow$	$D_2(g)$:	AID

これまでの研究でそのキネティクスについては基本的な事は分かってきている;

(1) ABS 反応は吸着 D に関して 2 次反応であり、AID 反応は 4 次反応である。

(2) 両反応とも入射 H フラックスに関しては1次の反応である。

討議事項

(1)時間応答¹⁾

H(g)ビームをパルス化し、発生する HD(g) 及び $D_2(g)$ の時間応答から ABS と AID 反応のキネテクスを調べた。その結果、HD 分子の生成は入射 H ビームのパルス波形に追随して起こり、反応時間は大変短い。それに対して、 D_2 分子の時間発展はHビームに追随する速い過程と、Hビームが遮断された後でも起こる遅い過程が存在し、反応過程は複雑である。 温度効果の実験などから AID 反応は(2x1)-H monohydride 表面に過度的に生成された (3x1)-H dihydride ドメインで起こる。

(2) レート方程式²⁾

これまでのキネテクスの知識を総括して、Si(100)表面に水素原子が吸着し、又その吸着原子を引き抜きながら一定状態 になる過程に対してレート方程式をたて、表面への水素取り込みと引き抜きを表面温度をパラメータにして計算した。計 算結果は実験による引き抜き反応の温度依存性の結果と良く一致し、キネテクスモデルの妥当性を確認した。

1) S. naga et al. Surf. Sci. in press

2) S. Inanaga et al. J. Vac. Sci. Technol. A. 23, 1471(2005)

Oral 11/25 AM02

Si(001)表面での水分子反応における水素結合ネットワークの役割

Role of the hydrogen-bonding network in promoted water reactions on Si(001)

加藤 浩之¹、赤木 和人²、常行 真司²、川合 真紀^{1,3} ¹理研、²東大院理、³東大院新領域

水は、日常的にもっとも多く接する分子であり、その振る舞いを明ら かにすることは、物理化学はもとより、合成化学、生物化学、大気化学、 宇宙空間における化学進化など様々な分野に関連する重要なテーマであ る。水が示す特異的な性質の多くは、水素結合ネットワークの形成に起 因している。本研究では「表面(界面)における水分子の解離反応や H/D 交換反応が水分子の凝集によって促進される」という現象を取り上 げ、水分子の反応における水素結合ネットワークの役割について検討し ている。

Si(001)表面での水分子反応実験は、全て超高真空下(2×10⁻⁸ Pa 以下) で行った。Si(001)試料は、液体窒素で90K以下に冷却することができ て、分子状の水を表面に凝集させることができる。実験では、試料温度 の制御によって、水素結合がある場合と無い場合を作り分け、水素結合 ネットワークの役割を、端的に比較検討することができた。測定手法と しては、反応物の生成量に関する測定をX線光電子分光法(XPS)、生成 物の同定を高分解能電子エネルギー損失分光法(HREELS)、反応前後の 顕微観察を走査トンネル顕微鏡(STM)を用いて行った。また、当反応系 は、原子レベルで制御された理想的な系であるので、第一原理計算を適



図. 水素結合ネットワークを介して、残存ダングリングボ ンドが反応する様子。STM像と理論計算結果。

用して、反応過程の詳細を吟味することが可能であった。

清浄なSi表面には、反応性の高いダングリングボンドがある。室温における水分子の反応では、解離片のHとOHが、 隣接するダングリングボンドをランダムに終端するため、最終的に離散的にダングリングボンドが残留する。我々は、水 分子をこの表面に一旦凝集させ、室温まで加熱することで、水分子が離散的に残るダングリングボンドを効率よく終端す る反応を見出した。これについて、理論計算による解析を行ったところ、孤立した分子が解離反応を起こすには、約2eV ものエネルギー障壁が存在するのに対し、凝集した水分子では、その障壁が、0.1eV にも満たないことが確認された。

Oral 11/25 AM03

ナノ構造化グラファイトにおける水素放出の第一原理シミュレーション

ab initio Simulation for Desorption of Hydrogen Atoms in Nanostructured Graphite

原田 晶子¹、下條 冬樹²、星野 公三³ ¹広大生物圈、²熊本大理、³広大総合科

水素は環境にやさしいエネルギー源として注目され、水素の貯蔵方法も含めて研究が進められている。水素の貯蔵方法 に関して、近年、実験により水素雰囲気中でグラファイトを粉砕して得られるナノ構造化グラファイトに多量の水素が吸 蔵されることが示された。水素吸蔵物質は、吸蔵量が多いことや軽量であることが応用上大切でありこの実験結果は重要 だが、水素がナノ構造化グラファイトに吸蔵・放出される際のミクロな機構は明らかになっていない。

最近、我々はグラファイトの層間に吸着した水素原子が放出されるミクロな機構を調べるため温度 1727 での第一原理 分子動力学シミュレーションを行い、水素原子がグラファイトから脱離する素過程を明らかにした[1]。

図に、炭素-水素および水素-水素原子間距離の時間変化を 示す。右上の挿入図は、シミュレーションに用いたスーパー セル(炭素原子 128 個、水素原子 4 個)内の 4 層のグラファイ ト面のうち、水素原子が吸着したグラファイト面を表す。シ ミュレーション開始時には、水素原子 H1,H2,H3,H4 はそれ ぞれ炭素原子 C1,C2,C3,C4 と結合しており、原子間距離 1 Å 付近で振動している。約 1.1ps 後に H1-C1,H2-C2 間の距離 は増加し、同時に H1-H2 間の距離は約 0.8 Åに減少する。こ れは水素原子 H1,H2 がグラファイトから脱離し水素分子を 形成したことを示す。形成された水素分子は、グラファイト 層間をかなり自由に運動するが、これは水素分子がグラファ イトの外に放出される可能性があることを示している。さら に、系の電子状態を調べることにより、脱離の過程で炭素-水素-水素-炭素の 4 原子間の電子密度が同程度になる"bridge state"を経由することが明らかになった。



この結果は、グラファイトに吸蔵された水素が高温で水素分子として放出される過程をシミュレーションではじめて再 現したものであり、炭素系物質における水素の吸着・放出の研究の進展に寄与すると期待される。 [1] A.Harada, F.Shimojo and K.Hoshino: J. Phys. Soc. Jpn. **74** (2005)2270.

Oral 11/25 AM04

アモルファス氷表面における CO と水素原子の反応

Hydration and deuteration of CO on amorphous water ice

渡部 直樹¹、日高 宏¹、長岡 明宏¹、⁰香内 晃¹ ¹北大・低温研

星間分子雲中の固体微粒子表面に固体として存在する水、ホルムアルデヒド、メタノール等は、低温での表面原子反応によって生成されたと考えられてきたが、実験的な研究は限られていた。私たちは、CO分子への水素原子逐次付加反応、CO→HCO→H₂CO→CH₃O→CH₃OH…(1)、に着目し実験的な研究を行ってきた。ところで、最近 H₂CO や CH₃OH などの星間分子に、重水素が極度に濃集していることが見つかり注目をあびている(たとえば、CH₂DOH/CH₃OH~0.3。宇宙存在度は D/H=10⁻⁵)。今回は、a)アモルファス H₂O 氷が下地として存在するかどうかで、反応(1)がどうなるか、b) CO分子へのD 付加反応はどの程度の速度で進行し、星間分子のD 濃集を説明できるかどうかを議論する。

超高真空容器中の Al 基板を He 冷凍機で 8-20K に冷却し、純粋な CO, CO-H₂O 混合物を蒸着した。それに、マイクロ 波放電で生成した H, D 原子 (~30K)を照射し、組成の変化を FTIR でモニターした。H, D 原子のフラックスは~5x10¹⁴ 個 cm⁻² s⁻¹であった。

純粋な CO に H を照射した場合、反応(1)は 8-10K までは、比較的速く進行したが、15K 以上では反応は起らなかった。 いっぽう、CO-H₂O 混合物では、反応(1)は 20K まで起った。このことは、アモルファス H₂O 氷が何らかの触媒的な働き をしている可能性を示唆する(単に、H の付着係数を増加させているだけかもしれないが)。(CO→HCO の反応速度定数) $/(H_2CO\rightarrow CH_3O の反応速度定数)=h(H)/k_3(H)=2$ であった。

純粋な CO および CO-H₂O 混合物に D を照射した場合も、定性的には H 照射の場合と同様な傾向を示した。しかし、 反応速度は全般的に小さく、**k**₁(D)/**k**₁(H)~0.1 であった。この結果を用い、反応 CO→HCO がトンネル反応であるとみな し、非対称 Eckart ポテンシャルを用いると、反応 CO→HCO の活性化エネルギーを推定することができた。

 $k_1(D)/k_1(H) \sim 0.1$ であるという結果は、重水素が極度に濃集している星間分子の生成を、単純な CO への D 付加では説明できないことを意味している。そこで、CO へ H と D を同時に照射する実験を 10K で行った。その結果、H₂CO や CH₃OH の D 体が、星間分子で観測されている値を説明できるくらい生成されることが明らかになった。さらに、D 体の生成機構を明らかにするために、H₂CO+D, CH₃OH+D, D₂CO+H, CH₃OH- d_n +H の実験も行った。この結果、H₂CO や CH₃OH の D 体は、H₂CO→HDCO→D₂CO, CH₃OH→CH₂DOH→CHD₂OH→CD₃OH のような H-D 置換反応で形成されることが明らかになった。

Oral 11/25 AM05

二重水素結合系における複合的トンネル効果

○関谷 博、迫田 憲治 九大院理

[序] DNA 塩基対などの二重水素結合をもつモデル分子系の二重プロトン移動(ESDPT)は、長年注目されて来た。最近、 我々は、10年来論争されてきた 7-アザインドール二量体(7AI2)の ESDPT 反応機構が協奏的機構である明確な実験的証 拠を提出した。同時に、二つのプロトンの運動における協同効果などこれまで注目されていない ESDPT の新しい側面を 見出した¹⁻³。7AI2のような二重水素結合系においては、プロトン移動のトンネル効果だけではなく、励起移動におけるト ンネル効果が観測される。ここでは、二つの複合的トンネル効果について紹介したい。

[実験] 超音速ジェット冷却された 7AI2 及び重水素置換体の電子スペクトルの測定を行った。また、ピコ秒レーザーで、 励起状態単一振電準位の減衰を共鳴多光子イオン化分光によって測定した³。

[結果と考察] 重水素置換されていない 7AI₂-hh 及び NH 基を重水素置換した二量体を用いて ESDPT 速度の H/D 同位体 効果を測定した。1 個の NH 基を D 置換した 7AI₂-hd の ESDPT 速度は 1/60、2 個の NH 基が ND 基に置換された 7AI₂-dd の反応速度は、7AI₂-hh の 1/720 である。このような顕著な同位体効果はトンネル効果による。ESDPT における同位体 効果が 1 個のプロトン移動よりもかなり大きいことは、ポテンシャル曲面の形状が二重プロトン移動と単一プロトン移動 では非常に異なることによる。7AI₂-hh 及び 7AI₂-dd の S₁-S₀ 遷移には一系列しか観測されない。エキシトン相互作用に よって振電状態が二重に分裂した場合には、gerade 対称をもつ状態への一光子遷移が禁制であるためである。しかしな がら、7AI₂-hd の電子スペクトルには、励起が一つのモノマーユニットに局在化するために二つの電子遷移系列が観測さ れる(図 1)。これらの結果から、7AI₂の励起移動は、Förster 機構の weak coupling case に分類される²。この場合、励 起移動座標に沿ったポテンシャルは二極小型となり、多次元的なトンネル効果によって振電状態の分裂が生じる。7AI₂-dd のゼロ点振動準位の二重陽子移動時間と励起移動時間は、それぞれ 1ns、3 ps と決定された。したがって、1 回の二重陽 子移動の間に局在的に励起されたモノマーユニットのスイッチングが数 100 回生じることになる。このような複合的なトンネル効果の解明は、新しい研究課題である。





図1. (a)7AI₂ -*hh/- hd/- dd* が混ざった試料の励起スペクトル。(b)、(c)は7AI₂-*hd*と7AI₂-*dd*のホールバーニングスペクトル。

1) H. Sekiya, K. Sakota, Bull. Chem. Soc. (Accounts) in press.

2) K, Sakota, H. Sekiya, J. Phys. Chem. A 109, 2718 (2005); J. Phys. Chem. A 109, 2722 (2005).

3) K. Sakota, C.Okabe, N. Nishi, H. Sekiya, J. Phys. Chem. A 109, 5245 (2005).

トリチウム固体中の蓄積³Heへの負ミュオン移行率の温度依存性

Temperature dependence of muon transfer rate to the accumulated ³He in T₂ solid observed in the muon catalyzed t-t fusion process.

 松崎 禎市郎、石田 勝彦、河村 成肇^A、今尾 浩士^{AB}、松田 恭幸、岩崎 雅彦、永嶺 謙忠^C、

 加藤 岑生^D、須貝 宏行^D、中村 哲^E、瓜谷 章^F、原野 英樹^F、G.H.Eaton^G

 理研、高工研^A、東大理^B、California 大^C、原研^D、東北大理^E、産総研^F、RAL^G

理化学研究所は、英国 Rutherford Appleton 研究所 ISIS 施設内に理研-RAL ミュオン施設を建設し、そこで得られるパルス状大強度負ミュオンビームを用いて d-t 系および t-t 系のミュオン触媒核融合実験を行っている。この度、トリチウム(T_o) 固体標的を用いてミュオン触媒 t-t 核融合実験を行った。

負ミュオンはトリチウム固体標的中に止まると t μ 原子を形成し、さらに t μ 原子は固体中で熱化しながら T₂分子と衝突し tt μ 分子を形成する。t-t 核融合反応はその分子内で起こり、負ミュオンは再び自由になってミュオン触媒核融合過程を繰り返す。

一方、tµ 原子は、固体中で熱化しながら固体中に蓄積した³He(トリチウム崩壊生成物)と衝突し、3体の束縛状態で ある t³Heµ 分子を形成した後に、負ミュオンはt原子から³He原子へと移行してµ³He原子を生成する。

この実験では、トリチウム固体標的温度を 5K-20K の範囲で変化させ、t-t 核融合率とミュオン移行率の温度依存性を 測定した。その結果、t-t 核融合率には顕著な温度依存性は見られなかったが、ミュオン移行率には興味ある温度依存性 が観測された。観測したミュオン移行率は 20K から 15K への温度下降に伴っては理論予測通りに上昇するが、14K から 11K へと温度を下げるに従い減少した。現在、この現象の解明を進めているところであるが、トリチウム固体中での³He 蓄積サイト、³He 蓄積過程、tµ 原子の熱化過程、tµ 原子と³He との衝突確率、トリチウム固体結晶構造、等の温度依 存性を検討する必要があると考える。

講演では、ミュオン触媒 t-t 核融合実験や実験結果について報告し、一つのモデルを用いて実験で得られたミュオン移行率の温度依存性を解釈することを試みる。

Oral 11/25 PM01

ワイドギャップ半導体の n型電気伝導性起源についてのµSR 法による研究

µSR study on the origin of *n* type conductivity in wide gap semiconductors

下村 浩一郎¹、門野 良典¹、西山 樟生¹、R.L.Lichiti² 1高エネ研、²テキサス大

我々が日々実感しているように、現代生活は半導体を使いこなす技術の上にますます深く依存するようになっている。 もちろん、現在主に使われているシリコンを基盤にした技術は既に成熟したものだが、より高速で、より低電力で、ある いはより過酷な条件で使えるものを、といった半導体材料の開発とその物性制御は依然として最先端の研究課題である。 半導体の物性制御で一番重要なのはその伝導性の制御であるが、よく知られているように半導体の伝導性は非常にわずか の不純物で敏感に変わるため、そのような不純物原子の半導体結晶中における電子状態の理解は半導体物理の主要なテー マの一つである。そのなかでも次世代オプトエレクトロニクス、光触媒の母材料として、窒化ガリウム(GaN)、酸化亜鉛 (ZnO)、二酸化チタン(TiO₂)などのワイドギャップ半導体は近年、広く注目を集めている物質群である。

本講演では、これらの半導体において長年謎とされてきた、n型電気伝導性起源について 水素がドナーとなる可能性を示唆する最近のµSR 法による研究結果について紹介する。[1-3] 参考論文

- 1. K. Shimomura et al., Phys. Rev. Lett. 89, 255505 (2002)
- 2. K. Shimomura et al., Phys. Rev. Lett. 92, 135505 (2004).
- 3. K. Shimomura *et al.*, Physca **B** in press

有限温度領域での超流動とPdH(D)x系の水素状態相図

Occurrence of Finite Temperature Range Superfluidity and PdH(D)x Phase Diagram

久保田 実¹、荒木 秀明²、原田 修治³ ¹東大物性研、²長岡高専、³新潟大工

高密度系での超流動現象は、これまでヘリウムの二つの同位体 ⁴He 及び ³He の液体、そして金属等の伝導電子系で研究 されて来た。1995年に実現、発見された稀薄気体系での超低温でのボーズ凝縮は、統計性によって起る量子凝縮相転移と 粒子間の相互作用によって引き起こされる気液固体等の相転移との関係に着いて新たな視点を蘇らせた。1960年代末から 盛んに議論され、一時は多数の実験的取り組みがなされた固体水素でのボーズ凝縮と超流動観測の試みが、その当時は「見 えざる本番」の序曲となり得たのは、昨年の固体ヘリウムでの超流動発見によってである。本講演では、ヘリウムと電子 系以外の系でボーズ凝縮や超流動現象が起きうるのか、我々がこの 7-8年に亘って研究して来た二つの系について紹介す ると共に、両者に共通する有限温度領域で起る「超流動に似た現象」について報告する。これらの現象が本物の超流動で あるかどうかの判定は今なお、多くの理論並びに実験研究の展開を必要としている。一つは、ガラス基盤上の He 薄膜の 系で、2次元超流動として良く知られる KT 転移がおこるよりも更に薄い単原子膜程度の「不活性層」と呼ばれて来た層 での 2 次元相図と「超流動に似た現象」1]であり、もう一方は、PdH(D)x系の所謂 50K anomaly と呼ばれる現象の周辺 での出来事である。

これまでに知られている電荷を持たない系での超流動現象は、全て、ある転移温度 Tc 以下絶対零度まで超流動現象が 続く。これは、理想系で起るボーズ凝縮現象と軌を一にするものである。電子系で見ればある有限温度領域でのみ起る超 伝導現象は、超伝導と磁性があい拮抗する様な系で re-entrant superconductivity として知られている。磁化が顔を出さ ないヘリウム系であっても粒子間の相互作用によって起る気液固体の三態変化と量子凝縮現象が本質である超流動とは、 入れ子になりうる事は想像がつく。が、実際にこれらを議論したものは最近まで皆無であった 2]。ここでは、最近我々が 見いだした PdHx 系での Tp 以上で起る有効質量減少の観測と、1]で見られた矢張りある有限温度領域でのみ出現する「超 流動に似た現象」を対比し、新たな超流動の可能性に付いて議論したい。PdHx 系では、これまで我々は水素濃度によっ て直線的に変化する相境界を比熱ピーク温度から見いだしたし、また、そのピークの大きさが、あたかも vacancy の密度 に比例して大きさが変化する事を見いだしている。超流動や、ボーズ凝縮と関連している現象が起きているとすれば、必 ず臨界温度が我々が見た Tp 以上の温度で見つかるはずである。これを見つける実験的試みと、高温異常は、この系では 大変小さくて見い出すのが困難であろうという議論とを紹介する。

Oral 11/25 PM03

Pd-H(D)合金の電気抵抗変化

Electrical resistivity change of Pd-H(D) alloys

山川 浩二 愛媛大工

水素を添加した Pd には"50K 異常"と呼ばれる 50K 近傍で種々の物性たとえば電気抵抗、比熱、ホール係数などが異常な 振る舞いをする現象がある。これらの異常な振る舞いは中性子回折による研究から格子間位置にランダムに分布していた 水素(重水素)がオーダリングすることに起因することが判明している。電気抵抗は一般的には水素(重水素)のオ・ダーリン グと共に減少するべきと考えられるがオーダリングの初期に実際には増加している。以前報告したようにこの Pd 中の水 素(重水素)のオ-ダリングによる電気抵抗増加はオ-ダリング初期のみに限られる。比較的に低温領域での等温焼鈍では電気 抵抗は極大値を取った後、減少する。すなわち、水素(重水素)の場合もオーダリングすると電気抵抗は減少すると結論で きる。

水素(重水素)のオーダリングの初期の電気抵抗増加の原因を明きらかにするために種々の降温速度、昇温速度での電気 抵抗変化を測定した。結果の1 例を図1(a),(b)に示す。同一試料を、(a)では同じ速度10K/min で冷却後、また(b)では 0.1K/min で冷却後、種々の速度で昇温して得られた電気抵抗曲線である。昇温速度が遅い場合に曲線は2 個の極大を持 つことが明らかである。(従来は1 個の極大のみが報告されていた)

また、(a)図と(b)図で同一の試料、同一の昇温速度にもかかわらず異なった曲線になる。これらの結果はオ-ダ-領域の核 生成及びそれらの成長で矛盾なく説明できる。



図1 同一試料を異なる冷却速度で冷却した後の、種々の昇温速度での電気抵抗曲線

Oral 11/25 PM04

希土類金属水素化物の電子転移

Electronic Transition in Rare-earth Metal Hydrides

青木 勝敏¹、町田 晃彦¹、大村 彩子¹、綿貫 徹¹、中野 智志²、竹村 謙一² ¹原研機構、²物材機構

希土類金属(La, Y)は水素化反応によって絶縁体に転移することが知られている。水素原子は hcp もしくは fcc 金属格子の四面体サイトをまず占有し(MH₂)、次に八面体サイトを占有する(MH₃)。金属-絶縁体(M-I)転移は 3 水素化物形成過程で起こり、バンドギャップ~2eVの可視光領域で透明な絶縁体が生成する。3 水素化物の電子バンド構造計算による M-I 転移の機構解明研究は転移が発見された 1996 年以降、精力的に行なわれているが~2eV のギャップ形成の再現には成功していない。

高圧実験の目的は二つである。絶縁体である3水素化物を加圧し、金属格子の収縮あるいは構造転移に伴う光学ギャップを測定し、構造と電子状態の関係を系統的に調べることが一番目の目的である。二番目の目的は、より高い圧力下で3水素化物のバンドギャップを閉じ、金属状態を実現することである。s(H)-d(Y) 混成によってギャップが開いて絶縁体になる、というバンド計算の結果から、高圧下でバンドオーバーラップによって出現する金属は水素の1s 軌道がフェルミ面形成に関与した「1s 金属」として特徴付けられるであろう。

ダイヤモンドアンビルセル (DAC)を用いて、流体水素と金属の高圧反応による水素化物の合成と X 線回折による高圧結 晶構造測定および光吸収測定による水素-金属結合状態と電子遷移状態の観測を、Sc,Y, La を対象に室温下、 \sim 50GPa ま での圧力領域で行なった。その中で、YH₃は 10GPa 付近で hcp-fcc の構造相転移を、さらには高圧 fcc 相は 23GPa で I-M 転移を起すことが観測されている。

YH3のI-M転移は、バンドギャップが圧力上昇に伴って連続的 にではなく、23GPaで不連続に閉じるという特徴を持つ。さらに、 転移前後でfcc金属格子の構造変化は無く、格子定数の不連続な 変化も観測されていない。従って、I-M転移の機構としては水素 原子位置の不連続変位によるs-d混成状態の変化が考えられる。 金属格子を保ったまま水素原子の変位による電子転移は光照射に よるスイッチング現象などの可能性を含んでおり、興味が持たれ る。ラマン散乱測定による転移前後の水素原子振動状態の測定な ど、実験による機構解明を今後目指していく。



YH₃の赤外透過スペクトルの圧力変化。 23 GPa で不透明になる。

新規第一原理計算手法による水溶液中の酸化還元反応解析

Redox reactions in aqueous solution by new ab-initio molecular dynamics methods

館山 佳尚¹、J. Blumberger²、M. Sprik³、大野 隆央¹ ¹物材機構、²ペンシルバニア大学、³ケンブリッジ大学

溶液中の酸化還元反応は電池、腐食、触媒、光合成など最近注目されている様々な現象の重要な素過程である。我々は これまで酸化還元反応の中でも特に電子移動反応に着目し、その反応において重要となる酸化還元電位や再配置エネルギ ーなどの諸物理量及び反応の微視的過程を予言できる新しいタイプの第一原理計算手法の開発及びその精度実証を行い、 一定の成果をあげてきた。[1] それらの手法—「グランドカノニカル第一原理 MD 手法」及び「第一原理 MD 手法+エネ ルギーギャップ則」—は、従来の電子移動理論の研究でよく用いられている線形応答仮定や溶媒の連続体モデル・分子の 点電荷モデルといった近似を原理的に超えるものとなっており、そこで得られる結果は電子移動反応に関する基礎的理解 の進展に大いに寄与することが期待されている。

このような電子移動に加えてプロトン移動もまた溶液中の酸化還元反応の重要な要素である。我々は最近このプロトン 移動の関連する溶液中の電子移動反応の諸物理量の計算にも取り組み始めた。本発表ではその一環として行った、水溶液 中での水分子の解離が絡んだ遷移金属錯体の酸化還元反応に対して、上記の新規第一原理計算手法を用いて行った解析に ついて、その手法論も交えながら報告する。

[1] Y. Tateyama, J. Blumberger, M. Sprik, and I. Tavernelli, J. Chem. Phys. vol. 122, article no. 234505 (2005).

P02

ナノ多孔質ガラスに閉じ込められた過冷却水素の固化圧力測定

Measurements of freezing pressure of supercooled liquid H₂ confined in a nano-porous glass

石井 洋典、柴山 義行、白浜 圭也 慶応大理工

水素(H₂)は質量が小さいため低温ではヘリウムよりも強い量子効果が期待されるが、現実には分子間相互作用のため固 化が起こり、顕著な量子性は観測されない。しかし液体水素の固化を抑制して過冷却液体状態を保つことができれば、低 温でボース・アインシュタイン凝縮(BEC)および超流動を起こす可能性が指摘されている[1]。これまで、水素を孔径 6-8nm 程度の細孔をもつ多孔質ガラス(Vycor)に閉じこめることで 9-11K 程度までの過冷却が報告されているが、BEC や超流動を示す結果は得られていない[2]。

我々は、より低温まで過冷却させて量子液体状態を実現することを目的として、直径 2.5nm のナノ細孔を有する多孔質 ガラス (Gelsil) に閉じこめた水素 (*p*-H₂) の圧力測定を行っている。圧力からは多孔質ガラス中水素の圧力温度相図(固液転 移線)を決定でき、BEC や超流動転移に関する知見が得られると考えている。

圧力測定は、多孔質ガラスを入れたベリリウム銅製密閉型試料セルとヘリウムクライオスタットを用いて行う。セルの 一端はダイアフラム型圧力計になっており、多孔質ガラス中水素の圧力を直接測定できる。実験では、まず15Kに保たれ た触媒セルでオルソ-パラ変換を施した *p*-H₂をセルに導入し、導入管内の水素を冷却することで固化させて管をブロック し、セル内の水素のモル数が一定の状態にする。その後冷却・昇温を行い、圧力を測定する。

測定結果の一例を図1に示す。まずセル内のバルク水素の固化が起こり、固液共存線に沿って圧力が低下する。バルク 水素の固化が終了すると圧力は固液共存線を離れ、更に冷却すると11.6 K(A 点)および9.4 K(B 点)で圧力に異常(ディッ プ)が見られる。この圧力異常は昇温時には見られなかった。

この異常の原因を調べるため、セルに多孔質ガラスの代わりに同じサイズの銅ブロックを入れ、セル内にバルク水素の み存在する状況でも測定を行った(図 2)。この場合、多孔質ガラスで見られた圧力異常は観測されなかった。従って圧力 の異常は多孔質ガラスに閉じこめられた水素によるものであると結論されるが、その詳細については検討中である。

[1] V. L. Ginzburg and A. A. Sobyanin, Sov. Phys. JETP Lett., 15, 242 (1972).

[2] R. H. Torii et. al., Phys. Rev. B, 41, 7167 (1990); D. J. Brewer et. al., J. Low. Temp. Phys., 101, 317 (1995);
 M. Schindler et. al., Phys. Rev. B, 53, 11451 (1996).

P01



P03

Muon Transfer Reaction Studies in Solid Hydrogen and Deuterium Films with Argon Ions Implanted Non-Uniformly

ストラッサー パトリック¹、松崎 禎市郎²、石田 勝彦²、松田 恭幸²、岩崎 雅彦²、永嶺 謙忠³ ¹高工研、²理研、³California 大

At the RIKEN-RAL Muon Facility, an experiment was developed to perform X-ray spectroscopy with muonic atoms formed from ions implanted in solid hydrogen films. This project is part of an experimental program to extend muonic atom spectroscopy to the use of nuclear beams, including in the future RI beams, to produce radioactive muonic atoms.

This experimental setup was first used to investigate solid state effects in pure solid deuterium appearing in the scattering of muonic deuterium atoms (dµ) at low energy. A series of measurements were performed with argon ions implanted non-uniformly in pure solid deuterium films to study the diffusion process of dµ atoms by varying the distance between each implantation region. Even with an non-uniform target, very strong muon transfer μ Ar(2 \rightarrow 1) X-rays at 644 keV can be detected. Because of the strong reduction of the Bragg cross-section at low dµ collision energy in solid deuterium, the dµ atom mean-free-path is strongly increased, resulting in a very long diffusion length. A dµ atom diffusion length of nearly 20 µm could be extracted, which is consistent with the predicted value based on calculated cross-sections.

Similar measurements are now in progress with a pure solid hydrogen film. The latest experimental developments will be reported.

P04

Ab initio 経路積分法による二水素結合クラスター およびその同位体効果の解析

H/D isotope effect on the dihydrogen bond by *ab initio* path integral molecular dynamics simulation

○林 愛子¹、志賀 基之^{2,1}、立川 仁典^{1,3} ¹横浜市大院、²原研、³JST PRESTO

【序】近年、CH…π型や二水素を含めた新たなタイプの水素結合が注目を集めている。その中でも我々は N⁶·H⁶⁺…H⁶·Be⁶⁺ といった二水素結合を持つ NH₄⁺…BeH₂を解析してきた^[1]。他にも C や Li を含んだ C₂H₂…HLi といった二水素結合系も 報告されている。LiH の関与する分子間力は二水素結合だけでなく、π…Li 結合も見出されている。そこで本研究では、 アルカリ金属に対する C₂H₂…HM (M=Li, Na, K)の構造、電子状態の変化を解析する。さらに、*ab initio* 経路積分法を用 いて、温度効果、量子効果および同位体効果の影響も解析する。

【方法】C₂H₂…HM (M=Li, Na, K)における平衡構造および遷移状態の構造最適化を MP2/6-311++G**レベルで行った。 さらに核の量子効果を考慮するために、*ab initio* 経路積分 (PIMD) 法^[2]を用いた。PIMD 法では、核の量子性を量子的 Boltzmann-Gibbs 統計に従って古典粒子の集まり (ビーズ) として表現する。計算には、 $\Delta t=0.1$ fs で 10000steps の熱平 衡状態に達した後、40000steps 分の核配置をサンプリングした。温度は 300K に設定し、電子状態は MP2/6-311++G** レベルで評価した。 【結果】構造最適化した C₂H₂…HM (M=Li, Na, K)の様々な構造を図1に示 す。M=Li, Naの場合では、(I)のような二水素結合型よりも(II)の π …M 結合 型の方が安定であることがわかった。一方、M=K の場合、(II)は遷移状態で あり、(IV)のような最安定構造が見出された。これは KH 分子が LiH 分子に 比べて分極が大きくなり、H…H の二水素結合と π …K の結合といった 2 つの 結合によって、安定化したためと考えられる。

また PIMD 法では核の温度効果、量子効果を考慮することによって、M=Na の場合でも(IV)のように二水素結合も形成するということがわかった。H/D 同位体効果の結果は当日発表する。

[1] A. Hayashi, M. Shiga, and M. Tachikawa, *Chem. Phys. Lett.* **410**, 54 (2005).

[2] M. Tachikawa and M. Shiga, J. Chem. Phys. 121, 5985 (2004).

P05

高圧下における固体酸 CsHSO4のプロトン伝導と構造

Protonic conductivity and structure of solid acid CsHSO₄ under high pressure

山脇 浩、藤久 裕司、竹谷 敏、坂下 真実、千勝 雅之、本田 一匡 産総研 計測フロンティア研究部門

硫酸水素塩などの無機固体酸は電荷キャリヤとなる水素イオンを自ら有するプロトン伝導体である。その伝導機構は、硫酸四面体イオンの回転と水素結合を介したプロトン移動の2つの過程から成ると考えられており、四面体イオン間距離や水素結合ネットワークなどの結晶構造とプロトン伝導速度は密接に結びついていると考えられる。硫酸水素セシウム(CsHSO4)は典型的な固体酸プロトン伝導体であり、常圧ではⅡ相(単斜晶)から超プロトン伝導相であるI相(正方晶) ~ 140℃で転移することが知られている[1,2]。高圧下においてもいくつもの相の出現が報告され、超プロトン伝導の可能性が示唆されている高圧相もある[3]。しかし、相境界は明確でなく、提唱されている空間群も信頼できる結果とはいえない。我々は、温度-圧力相図、構造の圧力変化を明らかにし、各相におけるイオン伝導性を測定することで、プロトン伝導と構造の関係を明らかにすることを目的としている。高圧下でのラマン散乱スペクトルや粉末X線回折測定により、文献で報告されていたCsHSO4の各相の相転移圧力を改め、新しい相を発見するなど新しい温度-圧力相図を作成している。 圧力による室温 II 相の構造変化からは四面体イオンの向きが変わり近接酸素間距離の順序が入れ替わる事などが明らかとなり、構造変化とプロトン伝導性との関係に興味がもたれる。現在、高圧下でのCsHSO4各相の構造決定とイオン伝導測定を進めている。

参考文献

[1] A. I. Baranov et al., JETP Lett. 36, 459 (1982).
 [2] T. Norby et al., Solid State Ionics 77, 105 (1995).

[3] E. G. Ponyatovskii et al., JETP Lett. **41**, 139 (1985).



Fig. 1 Structure of CsHSO₄ phase II at 1.9 GPa and room temperature.



Fig. 2 Relative change in the ionic conductivities of CsHSO₄ at 0.1 GPa and 1.4 GPa.



Figure 1. Schematic illustration of different possible geometries of C₂H₂… HM (M=Li, Na, K) system (equilibrium and TS geometries).

P06

4.2 Kγ線照射固体パラ水素中 H₂⁺コアクラスターの減衰挙動及びその機構

Decay behavior and mechanism of H_2^+ core cluster in γ -ray irradiated solid p-H₂ at 4.2 K

刈谷 奏¹、牛田 考洋¹、北野 利明¹、熊田 高之²、熊谷 純¹ ¹名大院工、²原子力開発機構基礎セ

【緒言】1996年に宮崎らは 4.2 K γ 線照射固体パラ水素 (p-H₂)中に 4本の ESR シグナルを観測し、それらを H₂-による ものと同定した。その後これらのシグナルは H₂-, H₂+(H₂)₂のどちらでも説明がつき、同定には至らなかった。2004年に 我々は o-D₂(*I* = 0, 2)を高純度 p-H₂に添加し、o-D₂によるクラスター起因の超微細構造の観測の有無から同定を試みた。 その結果、従来観測されていた 4本の ESR シグナル以外に新たに複数の多重線の観測に成功し、宮崎らが報告した 4本 線を H₂+(H₂)₂ であると同定した。この 4本のシグナルは D₂を添加すると速く減衰する。宮崎らはこの減衰機構を H₂-か ら電子バブルへの変換と考えていたが、H₆+となった今、新たな機構の解明が必要となった。本研究では o-D₂添加により 新たに観測された各 ESR シグナルの減衰挙動から生成化学種の同定を試み、また減衰機構についても考察したので報告 する。

【実験】測定用石英セルに para-H₂(合成核スピン *I*=1), He(0.1%), ortho-D₂(1, 8%, *I*=0,2)を封緘し、4.2 K でγ線を 2.88 kGy 照射後、ESR 測定した(JEOL RE1X)。

【結果と考察】図1において観測された各 ESR シグナルの減衰速度を比較すると、B, C, D の3 種類に分類でき、その速度は B>C>D となった。この減衰挙動の相違、及びシグナル解析から D₂未添加の場合でも観測されたシグナル(B1~2)を H₆+、o-D₂を添加した場合観測されたシグナル C1~7、D1~4 をそれぞれ H₂+(p-H₂)(o-D₂)、H₂+(o-D₂)₂と同定した。 o-D₂を添加したサンプルにおいて、H₆+の減衰速度定数は 32×10⁻⁵ s⁻¹、H₂+(p-H₂)(o-D₂)では 8.9×10⁻⁵ s⁻¹、H₂+(o-D₂)₂ では 3.7×10⁻⁵ s⁻¹と o-D₂の置換数が多くなるほど減衰が遅くなる。従って、H₆+の両端の H₂が順に D₂へ置換されているものと推察される。一方、H₂+(o-D₂)₂の減衰については、照射固体水素の主生成物である水素原子と反応して、H₃+と 2 o-D₂ になっていると考えている。



P07

照射固体パラ水素中に生成する H2+(H2)n(o-D2)2-n(n = 0, 1, 2)の ESR 観測とその解析

Experimental observation of $H_{2^+}(H_2)_n(o-D_2)_{2-n}$ (*n* = 0, 1, 2) in γ -irradiated solid parahydrogen

熊谷 純¹、刈谷 奏¹、稲垣 宏樹¹、北野 利明¹、熊田 高之² 1名大院工、²原子力開発機構基礎セ

1995-96 年に宮崎等は 4.2 K の γ 線照射固体パラ水素中に 4 本の ESR シグナルを観測し、これらを para, ortho-H₂⁻と 同定した。H₂⁻の状態は不安定で気相では存在しない。固体水素中に最も簡単な分子アニオンである H₂⁻が存在するという 報告は理論家からも注目されたが、報告された g 値が H₂⁻であることと矛盾すること、超微細結合定数の値が、計算で求 めた H₂+(H₂)₂の値と非常に良く一致するなどの報告が相次いで出された。しかし、実験による宮崎等の報告の検証は行 われていない。もし H₂+(H₂)₂が生成しても両端の H₂がパラ水素の場合は合成核スピンが 0 であるから超微細構造が観測 できず、化学種を同定は難しい。本研究では、オルソ重水素 (o-D₂: *I*=0,2)を高純度パラ水素に添加した。o-D₂(*I*=2)の 置換した H₂+(H₂)(o-D₂)又はが H₂+(o-D₂)₂生成していれば、o-D₂による超微細構造の現れた ESR シグナルが観測される はずである。一方アニオン種ならば、クラスター形成に由来する超微細構造は見られないはずである。以上の考えに基づ き、ESR 測定用セルに p-H₂と He(0.1%)と o-D₂(1.3%)を封緘後、試料を液体 He(4.2K)に浸して固体パラ水素を作成し、名大コバルト 60γ線照射施設にて照射後に ESR 測定を行った。D₂を添加していない系では*で示した4本線しか観測されないが、o-D₂添加によって他に新たな多重線を観測し、o-H₂+(H₂)(o-D₂)及び o,p-H₂+(o-D₂)₂と同定できた(図1)。 o-H₂+(H₂)(o-D₂)においては、 p-H₂と o-D₂では質量が異なるために非対称となり、中心の o-H₂+の不対電子分布は2つの H上で異なるものになることもわかった。本研究で観測されたシグナルは、D₂⁻や H₂⁻のような単分子アニオンでは解釈不可能であり、宮崎らの報告した ESR シグナルは、H₂-ではなく H₂+(p-H₂)₂カチオンクラスターであることが明らかになった。



図1 4.2 Ky 線照射 p-H2- o-D2(1.3%)-He(0.1%)の ESR スペクトル

P08

低速陽電子ビームによる Ni(111) 水素吸着層の研究

The study of adsorbed hydrogen on Ni(111) surface by slow positron beam

広田 幸二¹、大石 陽次郎²、金沢 育三³、福谷 克之⁴、野沢 清和⁵、小森 文夫⁶ ^{1,2,3}東学大物理、⁴東大生研、^{5,6}東大物性研

固体表面における表面の吸着原始の動的挙動の現象の解明は、表面科学の重要な課題のひとつである。とりわけ、固体 表面と水素の相互作用については、科学的、工業的に興味深い。陽電子消滅オージェ電子分光(PAES)、反射高速陽電子 回折(PHEPD)、陽電子誘起イオン脱離といった陽電子を用いた研究手法は、陽電子が表面研究における強力なプローブ であることを示している。本研究では、再放出陽電子のエネルギー分布測定を行った。低速陽電子ビームラインを用い、 輸送過程で単色とした陽電子を試料に入射させる。加速エネルギーは 2KeV とし、試料にはイオンスッパタリング、フラ ッシングを繰り返し、よく清浄した Ni(111)と、水素吸着 Ni(111)について比較評価した。試料に正電位をかけ、試料前に グラウンドレベルのメッシュを置くことで、試料表面からの正荷電粒子はメッシュ方向に加速される。その延長上にチャ ンネルトロンを設置することで、正荷電粒子である再放出陽電子についての測定が可能となっている。またチャンネルト ロン直前に設置した電位可変メッシュにより、再放出陽電子のエネルギー分析を行う。清浄表面と水素吸着表面を比較し たとき、水素吸着表面において水素吸着効果による陽電子仕事関数の変化を確認しその値を見積もることが出来た。

P09

多成分量子モンテカルロ法による陽電子化合物の理論的解析

○北 幸海*、前園 涼**,[†]、立川 仁典*,[†]
 *横市大総合理学研究科、**物質・材料研究機構、[†]JST さきがけ

電子の反粒子である陽電子は、電子と衝突するとそのスピン状態に応じて、2~3個の光子を放出し消滅する(対消滅)。 この光子を検出することで物質の性質を探る陽電子消滅法は、構造欠陥や固体表面等の結晶に対する解析や、原子・分子 の電子状態を探るプローブ等の物性研究への応用から、陽電子断層撮影法 [PET: Positron Emission Tomography] 等の 医学・生理学への応用まで、非常に幅広い応用が行われている[1]。固体や液体に入射された陽電子は、対消滅を起こす前 に電子散乱やフォノン励起によりエネルギーを失って周囲と熱平衡に達する。この陽電子の衝突によりエネルギーが蓄積 された領域(陽電子スパー)内では、イオン化や励起原子・分子の生成、電子と陽電子が結合したポジトロニウム[Ps] 形成、 および Ps と電子受容体の Ps 化合物形成など、様々な反応が進行する事が知られているが、陽電子が結合した事による電 子状態の変化や構造変化等に対する知見は、十分明らかにはなっていない。 陽電子を理論的に取り扱う手法としては、多成分分子軌道 [MCMO] 法が良く用いられる[2]。MCMO 法は、プロトン・ 陽電子といった軽い粒子の量子効果を直接取り込むために、電子に対する分子軌道の概念をそれらの粒子にも拡張させた ものである。陽電子を"正電荷を持った粒子"に置き換える事により、MCMO 法による陽電子化合物の理論計算を行う 事が可能となる。しかし従来の手法では、電子-プロトン相関に比べて電子-陽電子相関を十分取り込む事が難しく、電子 -陽電子相関を正しく記述し得る、十分正確な波動関数が必要である事が報告されている[3]。第一原理量子モンテカルロ [QMC] 法、特に拡散モンテカルロ[DMC] 法は、系の正確な波動関数を記述する手法として、現在最も有望な候補である [4][5]。本研究の研究目的は、この DMC 法を電子だけでなく多成分系に拡張した、多成分量子モンテカルロ法 [MCQMC] の開発を行う事である。発表では [LiH;e⁺] 系や [CH3⁻;e⁺] 系に適用する試みについて報告を行う。

Reference:

- [1] 日本アイソトープ協会、陽電子計測の科学(1993)、立川仁典・季村峯生・L. Pichl「陽電子と分子の結合と高精度 PET スキャン」現代化学(東京化学同人), vol.414, 44-50 (2005).(in Japanese)
- [2] P. E. Cade and Abbas Faradel, J. Chem. Phys. 66 6(1977)
- [3] T. Saito, M. Tachikawa, C. Ohe and K. Iguchi; J. Phys. Chem. 100 6057(1996)
- [4] K. Hongo, R. Maezono, Y. Kawazoe, H. Yasuhara, M.D. Towler and R.J. Needs J. Chem. Phys., 121, 7144 (2004)
- [5] B. L. Hammond, W. A. Lester, Jr. and P. J. Reynolds, "Monte Carlo Methods in Ab Initio Quantum Chemistry" (World Scientific, 1994)

P10

核・電子の量子効果を考慮した多成分密度汎関数理論(MC_DFT)の開発

Development of Multi-component Density Functional Theory

○宇田川 太郎¹、立川 仁典^{1,2} ¹横市大院理、²JST-さきがけ

【Introduction】 水素結合系や水素移動反応に代表されるように、水素は幅広い領域で重要な役割を担っており、特に水素原子核自身の量子性が重要であることが見出されるようになった。我々は現在までに、分子軌道の概念をプロトンなどの軽い粒子に拡張した多成分分子軌道(Multi-component molecular orbital:MC_MO)法を開発し[1]、C-H…O型水素結合における幾何学的同位体効果の理論的予測[2]など、様々な応用計算を実行してきた。MC_MO法では核を量子力学的に取り扱うため、平均場近似を超えるためには電子相関のみならず電子ー核相関、核ー核相関といった興味深い多体効果を新たに考慮する必要がある。このような多体効果を取り込むため、我々は既に MP 法や CI 法[3]を適用したが、精密解への収束性や莫大な計算量といった課題が浮上してきた。そこで本研究では、このような多体効果を効率的に取り込むために、密度汎関数理論を多成分系に拡張する、多成分密度汎関数理論(MC_DFT)の開発を試みる。

【Theory】 プロトンを量子力学的に取り扱う場合のハミルトニアンは、以下のようになる。

$$H = -\sum_{i=1}^{Ne} \frac{1}{2} \nabla_i^2 - \sum_{A=1}^{M} \sum_{i=1}^{Ne} \frac{Z_A}{r_{iA}} + \sum_{i=1}^{Ne} \sum_{j>i}^{Ne} \frac{1}{r_{ij}} - \sum_{p=1}^{Np} \frac{1}{2M_p} \nabla_p^2 + \sum_{A=1}^{M} \sum_{p=1}^{Np} \frac{Z_A}{r_{pA}} + \sum_{p=1}^{Np} \sum_{q>p}^{Np} \frac{1}{r_{pq}} - \sum_{i=1}^{Ne} \sum_{p=1}^{Np} \frac{1}{r_{ip}}$$
(1)

ここで添え字 *e*, *p*は、それぞれ電子とプロトンに関する項を示す。多成分 Hartree-Fock (HF) 法では、全波動関数を電子 波動関数とプロトン波動関数の積で表す。通常の分子軌道法と同様に、HF 方程式に基底関数展開を導入することにより、 多成分 Roothaan 方程式が導出される。電子、プロトンに対する Roothaan 方程式を同時に解くことで、電子だけでなく プロトンをも量子力学的に取り扱った場合のエネルギー、波動関数が求められる。

MC_DFT 法では、電子相関については既存の汎関数で評価する。また、核一核相関は寄与が小さいため、無視することが可能となる。しかしながら電子-核相関は無視できず、電子-核相関用の新たな汎関数を作成する必要がある。そこで本研究では Colle-Salvetti 型関数を用いた LYP 相関関数[4]に着目する。LYP 相関関数では、電子相関に関して HF の 1 体および 2 体の縮約電子密度を用いる。これを電子-核相関へと拡張し、相関エネルギーの各パラメータを fitting しなお すことによって、電子-核相関をも評価することが可能になると期待される。さらに MC_MO 法と MC_DFT 法を組み合わせることにより、MC_BH&HLYP 法を定義する。この場合の Fock 演算子は

$$f_{MC_BH\&HLYP} = (f_{MC_{HF}} + f_{MC_{BLYP}}) * 0.5$$
(2)

となる。現在は、プログラムの開発を行っている最中であり、結果については当日発表する。

M. Tachikawa, K. Mori, K. Suzuki, and K. Iguchi, Int. J. Quantum Chem. 70, 491-501 (1998), M. Tachikawa, K. Mori, H. Nakai, and K. Iguchi, Chem. Phys. Lett. 290, 437-442 (1998).

[2] T. Udagawa, T. Ishimoto, H. Tokiwa, M. Tachikawa, U. Nagashima, Chem. Phys. Lett. 389, 236-240 (2004).

- [3] M. Tachikawa, Chem. Phys. Lett. 360, 494-500 (2002), M. Tachikawa, H. Sainowo, K. Iguchi, and K. Suzuki J. Chem. Phys. 101, 5925-5928 (1994).
- [4] C. Lee, W. Yang, and R. G. Parr, Phys. Rev. B 37, 785-789 (1988).

低温度領域下におけるパラジウム中の水素の動的振舞い; 捻じれ振り子実験から

Dynamical behavior of hydrogen in palladium in low temperature region by means of torsional oscillator method

今井 彰夫¹、原田 修治²、Andriy Penzev³、久保田 実³ ¹新潟大自、²新潟大工属、³東大物性研

パラジウムは水素を多量に吸蔵する金属であり、水素は Pd の O サイト格子間を占める。この水素の特徴として、質量 が軽いため量子効果が顕著に現れる。例えば、低い温度でも大きな拡散係数を持つことから、水素の量子効果は比較的高 い温度まで現れると考えられる。また、水素の高濃度領域においては、波動関数の系全体に亘る重なりにより、量子凝縮 が起こることが期待される。これまで我々は Pd 中の水素の状態を調べるため、水素化によるエントロピーの変化に関す る情報を比熱の精密測定により得てきた。低温度領域において 55K 異常と呼ばれる現象が知られ、この現象はこれまで Pd 中水素の規則-不規則転移によるものだと考えられてきた。しかしながら、我々の比熱測定で得られた比熱のピークの 温度依存性とエントロピーの変化の解析から、従来の考え方では説明できないことが分かった¹⁾。だが、比熱から水素原 子の量子的な運動状態に関する情報を分離することは困難であり、この実験結果からだけでは、水素の状態についての明 確な結論が得られない。そこで、水素の運動状態を直接観測するために、超流動の研究に使用されてきた高感度捻じれ振 り子 (Torsional-Oscillator、以下 TO)を用い研究を行っている。これまでに行った TO の予備実験から、55K 異常が現れ る温度以上において水素の有効質量が軽くなる方向への共振周波数のシフトと、このシフトに対応する温度での*Q*値の鋭 い低下から大きなエネルギー散逸が認められている。しかしながら、この予備実験は GE ワニスを用いて試料を固定して 行ったものであり、十二分な注意を払ってはいるが、試料の取り付けが一定せず、再現性に問題があった。そこで、この 問題を改善し、再現性の良い測定を行うことを目的とした。

他方、近年、固体状態の⁴He において超流動現象が認められるとの実験的な報告が M. Chan 等によりなされた²。さらに、D. E. Galli 等により、固体 He 中の空格子と格子間 He 原子の対がこの有限温度での超流動に対して、重要な役割を担うことが理論的な立場から報告されている³。金属中の水素の状態は固体⁴He とは異なるが、高濃度状態での水素原子に対し、量子統計に由来する巨視的な量子現象が期待される。発表ではこれらの測定結果から、Pd 中の水素の運動状態について議論を行いたい。

この実験は、東京大学物性研究所・久保田研究室との共同利用プログラムで行われた。

(1) H. Araki, S. Harada, M. Kubota, J. Phys. Chem. Sol. 61(2005)1490-1492

(2) E. Kim and M. H. W. Chan, Nature 427 (2004) 225.

(3) D. E. Galli, L. Reatto, J. Low Temp. Phys. 124 (2001) 197

P12

2次元水素結合系四角酸中のµSR

µSRin in 2-Dimensional Hydrogen Bonding System: Squaric Acid

西山 樟生¹、下村 浩一郎¹、西山 純江¹、髭本 亘²、久保 謙哉³ ¹高工研、²原研、³ICU

四角酸は非常に2次元性の強い水素結合系としてよく知られている。軽 い水素の同位体であるミュオンの四角酸中における占有位置、拡散などの 挙動を明らかにするために単結晶の四角酸を標的とし、ゼロ磁場 µSR 法 を用いて、ミュオンスピンの緩和の温度変化の測定を行った。 その結果低温において、ミュオンは水素と結合していない酸素と結合し µ-O ボンドを形成するが、300K では本来水素の入っているサイトに入れ 替わって入っていることが、核磁気双極子による幅の結晶軸依存性の計算 と実験(図1)から明らかになった。また低温の占有位置からのミュオン の移動は 100K から始まっており、220K 近傍で双極子幅またはミュオン 緩和が最小になっている。水素の秩序化の温度 380K 前後で緩和に変化が 見られているが、核磁気双極子幅の計算からは、説明できていない。



図1、四角酸中のミュオンの緩和幅

Si(001)表面における水分子の解離反応および H/D 交換反応: 水素結合形成による反応性変化の理論計算による検討

Dissociation of Water Molecules and H/D Exchange Reaction on Si(001) Surface : Hydrogen Bond Formation and Change in Reactivity

赤木 和人¹、加藤 浩之²、川合 真紀²、常行 真司¹ ¹東大院理、²理研

水素結合は水分子同士を結び付けるだけでなく、それ自身がプロトン の伝達経路として働きうる点で興味深い。このプロトン伝達は、水分子 の HOMO-LUMO と強く相互作用できる分子軌道を持つ溶質分子や固 体表面と接触したとき、あるいは水素結合ネットワークにおいて H と OH の数のバランスが崩れたときに著しく活発になり、「水分子集団」と して化学反応性が大幅に増す。

Si(001)清浄表面は表面科学の分野ではよく用いられる試料である。 また、水分子は真空容器の汚染物質であり、Si(001)清浄表面でも容易 に解離吸着して欠陥を生成するため嫌われがちな物質である。しかし、 水分子のSi(001)清浄表面での解離吸着の進行を詳細に調べてみると、 水分子が集団を作ったときに反応性を増すメカニズムが明らかになって きた。このとき、反応前の水素結合では酸素-酸素間距離の10%以上の 短縮と、この酸素-酸素間でプロトンが感じるポテンシャルの平坦化を伴 う強い変性が生じていることは特徴的である。

今回われわれは、(1)低温で表面に水分子を凝集させると、室温の真 空条件下での場合と比べて残存した孤立 dangling bond の数が減少する という実験結果や、(2)水の解離吸着で生じた Si(001)表面の Si-OH は、 Si-H と異なり、凝集した水分子との間で H/D 交換反応を容易に起こす という実験結果に対し、密度汎関数計算による理論的アプローチを行な い、凝集した水分子間に形成される水素結合の役割に注目した議論を行なう。



図:水分子の(a)単分子過程による解離吸着と (b)2 分子過程による解離吸着。後者のエネルギ 一障壁は前者のそれに比べて著しく低下する。

P14

「Ir(111)上の吸着水素原子間の相互作用」

Interactions between hydrogen atoms adsorbed on Ir(111) surfaces

中西 寬¹、笠井 秀明¹、福谷 克之²、岡田 美智雄³ ¹阪大院工、²東大生研、³阪大院理

これまで、金属表面に吸着した水素の量子状態を実験 [1]、理論計算[2-5]の両面から調べてきた。計算では、水 素原子の位置座標の関数とした電子・イオンコア系のト ータルエネルギーを密度汎関数理論をもとにした第一原 理計算で求め、水素の運動におけるポテンシャルエネル ギー超曲面とし、そのポテンシャル超曲面上の水素原子 の量子状態を求めた。Pt(111)表面上の水素原子につい て零点振動(基底状態)の運動量分布の計算結果[3]は、 共鳴核反応(NRA)による測定結果とよく一致した。し かし、Ir(111)表面上の水素原子については、HREELS で観測されている振動モードに対応する励起状態は計算 結果[5]に存在したが、零点振動の表面垂直方向の運動量 分布は、計算結果の方が NRA の実験結果よりブロード な分布を示していた。

図中の点線は先の計算に用いた水素のポテンシャル



図. I r(111)表面で水素原子が受けるポテンシャルエネルギー

エネルギー(被覆率 θ = 1/4 に相当)である。ポテンシャルエネルギーが最も低くなる、オントップサイトに水素原子が 局在し、表面垂直方向に強く束縛されるため運動量分布がブロードになっていたものと思われる。実線は、θ = 1/9まで 下げた場合のポテンシャルエネルギーの計算結果である。オントップサイトでは、あまり変化がないが、FCCフォローサ イトでのエネルギーが、下がっているのが分かる。FCC ホローサイト周りに水素原子が存在すれば、閉じ込め効果が緩和 することにより表面垂直方向の運動量分布は、NRA による測定結果が示すとおりナロー化するものと考えられる。講演 では、ここで示唆される FCCフォローサイトでの吸着水素間相互作用について考察する。

[1] K. Fukutani, et al., Phys. Rev. Lett. 88 (2002) 116101.

[2] K. Nobuhara, et al., J. Appl. Phys. **91** (2002) 1855.

[3] K. Nobuhara, et al., Surf. Sci. 507-510(2002) 82.

[4] K. Nobuhara, et al., Surf. Sci. **493**(2001)271.

[5] K. Nobuhara, et al., J. Appl. Phys. 96 (2004)5020.

P15

Cu(100)及び Cu(110)表面における水素原子の量子状態

Quantum states of hydrogen atom on Cu (100) and (110) surfaces

尾澤 伸樹、Tanglaw Roman、中西 寛、笠井 秀明 阪大院工

近年、水素の動的振る舞いは実験・理論共に積極的に研究されてい る。また、水素は他の元素と異なり、その質量の小ささから顕著に量 子効果を示すため、それに伴う非局在化、またそれに及ぼす同位体効 果なども研究されている[1-3]。本研究では、まず Born-Oppenheimer 近似の枠内で水素原子が Cu(100)及び Cu(110)表面から受けるポテ ンシャルエネルギー曲面(Potential Energy Surface: PES)を密度汎 関数理論による第一原理計算を用いて構築し、その PES 上での水素 原子の運動の波動関数及び固有エネルギーを計算し、水素原子の量子 状態を解析した。その結果、水素原子は Cu(100)上では基底状態で Hollow(HL)サイトに強く局在し(図 1)、励起状態ではエネルギーが 増加するに従って HL サイトを中心に波動関数が広がっていく。一方、 Cu(110)上ではShort-Bridge(SB)サイトを中心にPseudo-Three-fold (PT)サイトにかけて局在し(図 2)、励起状態では SB サイトを中心と した振動モードと Long-Bridge(LB) サイトを中心とした振動モード の二種類が存在している。また、同位体原子の Cu(100)と Cu(110) における量子状態を計算すると、その波動関数及び固有エネルギーは 異なる特徴を持った振動状態を示す結果となった。本講演ではこれら の結果及びメカニズムについて報告する。

Y. Miura, et al., Surf. Sci. 507-510 (2002) 838.
 K. Nobuhara, et al., J. Appl. Phys. 96 (2004) 5020.

[3] N. Ozawa, et al., Surf. Sci. submitted



図1 Cu(100)表面上における水素原子の波動関数 縦軸及び横軸はユニットセルに対応した座標〇 は第一層 Cu 原子をあらわしている



図2 Cu(110)表面上における水素原子の波動関数 縦軸及び横軸はユニットセルに対応した座標〇 は第一層 Cu 原子をあらわしている

P16

超短パルス高強度レーザーによる固体薄膜からの高速プロトン発生

Fast Proton generation from a thin foil irradiated by ultra-short high intensity laser pulses

余語 覚文^A、西内 満美子^A、福見 敦^{A,B}、黎 忠^{A,B}、小倉 浩一^A、織茂 聡^A、加道 雅孝^A、
 匂坂 明人^A、林由 紀雄^A、森 道昭^A、A. Porozhkov^A、大道 博行^A、中村 衆^{A,C}、岩下 芳久^C、
 野田 章^C、大石 祐嗣^D、名雪 琢弥^D、藤井 隆^D、根本 孝七^D
 ^A原子力機構、^B放医研、^C京大化研、^D電中研

集光強度が 10¹⁸W/cm²を超える短パルス高強度レーザーを薄膜ターゲットに照射すると、レーザー光電場の1周期で電子が相対論的エネルギーまで加速される。このとき生成されるプラズマは相対論的プラズマと呼ばれており、硬X線、高

速電子、高速イオンの発生といった数々のユニークな現象が起こる。我々はイオン加速器の小型化を目指して、レーザー プラズマ駆動イオン加速器の開発研究を進めている。

近年の研究[1,2]では、パルス幅 100fs 以下の高強度レーザーパルスを厚さ数ミクロンの金属薄膜に照射することで、薄膜の裏面方向に MeV 級エネルギーのプロトンビームが発生することが実験的に明らかになった。このとき加速されたプロトンは、薄膜表面に存在する不純物分子に起因するものと考えられる。しかしながら、現在までの研究では、薄膜の物性や表面の状態に注意を払った研究はほとんど無い。シミュレーション計算[3]では、清浄な金属薄膜の表面にナノメートル以下のごく薄い水素層を付加すると、60MeV 程度のプロトンが発生することが示された。今後、実験的により高エネルギーのプロトン加速を実現するためには、固体での水素の性質・物性を考慮した薄膜の製作が不可欠であると考える。

本発表では、日本原子力研究開発機構関西光科学研究所、および電力中央研究所横須賀研究所で行ったイオン加速実験の結果を報告する。ここでは集光強度 9X10¹⁸ W/cm² のレーザーパルスを厚さ 5µm の銅薄膜に照射することで、最大エネルギー1.5MeV のプロトンを得た。このほか、金属薄膜の表面をポリスチレンで被覆した二層ターゲットを用いた実験結果など、薄膜製作の現状について紹介する。

[1] K. Matsukado *et al.*, Phys Rev. Lett. **91**, 21501 (2003)

[2] A.J. Mackinnnon et al., Phys Rev. Lett. 88, 45003 (2002)

[3] T. Esirkepov et al., Phys Rev. Lett. 89, 175003 (2002)

P17

ガラス基板上Heの「不活性原子膜」の精密捻り振子実験による2次元相図

He 2D phase diagram studied by high precision torsional oscillator experiment

福田 宗行^{1,2}、久保田 実¹ ¹東大物性研、²現日立中研

固体表面上に形成された He 原子薄膜は理想的 2 次元系として様々な基礎物理学の研究の場を提供している[1]。相転移 の最も理想的なものと考えられ臨界現象の研究に盛んに使われる 3 次元系での超流動転移は、基本的にはボーズ・アイン シュタイン凝縮という量子統計性から理想気体系で起る有限の温度で起る相転移と関連づけられる。一方、粒子間の相互 作用で起る気液固体間の相転移は、ヘリウム以外の物質では飽和蒸気圧下でも観測される。ヘリウムは例外で加圧しない と固体が出来ない。しかしこれは、基盤上に形成される 2 次元系では異なり、ヘリウム 4 であっても気体液体固体の 3 態 が存在する事が最近の実験で確かめられた[2]。2 次元の超流動転移はボーズ凝縮ではなしにコスタリッツ・タウレス (KT) 転移[3]で通常説明される。KT 超流動転移と 2 次元気液固体の 3 態の関係は、Dash により指摘され[4]、いくつかの実験 的取り組みもなされたが、これまで明らかになって来なかった[5]。一方、経験的に様々な固体の表面に形成される He 薄 膜は固体の van der Waals 引力によって決まる膜厚 ne まで「不活性な固体」が形成され、その上に 2 次元液体超流動膜 が出来ると考えられて来た[6]。

我々は、高安定、高感度の捻り振り子法を用い、ガラス基盤上の He「不活性層」を注意深く研究した。「空」のセルで 観測した後、He 膜厚を~1/5~1/10 原子層に対応するくらいづつ、

吸着させ、anneal した後約 50mK の最低温まで冷やしゆっくり昇温しながら観測を行った。この不活性層が実は、2 次元 固体気体共存領域と、気液固体の 3 態が共存する密度・温度線が存在し、その温度以上に気液共存状態と考えられる状態 を見いだした。実はこの相で有効質量の減少を観測した。この原因としては次の事柄が考えられる。1). 超流動現象、2). 薄膜の基盤からの脱離(3D 気化)、3). Slippiga 等の新しい 2 次元現象。3). には 2 次元系内での「蒸発」現象も考えられ るが、2 次元気体の粘性についての議論は著者は知らない。3D 蒸発現象の違いから相図を提案する。また、超流動の可能 性に付いて議論する。

1]. See for ex. Fukuda, et. Al. Phys. Rev. B71, (2005) 212502 and references therein.

2]. R. Ramos and O. Vilches, J. Low Temp. Phys. 134, 55-60. (2004) and ref. therein.

3]. Kosterlitz and Thouless, J. Phys. C5, L124 (1972), C6, 118 (1973).

4]. J. G. Dash, Phys. Rev. Lett. 41, (1978) 1178.

5]. Crowell and Reppy, Phys. Rev. B53, (1996) 2701.

6]. Csathy, Reppy, Chan, Phys. Rev. Lett. 91, (2003) 235301.

P18

新しい第一原理計算手法による固体水素のバンドギャップの圧力変化

Pressure dependence of the band gap in solid hydrogen calculated with a new ab-initio approach

佐久間 怜、常行 真司 東大院理

固体水素は低圧では分子状の絶縁体であるが、圧力を加えていくことで金属への転移が起こると期待されている。しか し高温を除き、実験的にはいまだ金属化は成功しておらず、その転移圧力や転移機構は実験家や理論家の興味の的となっ ている。実験で到達することの難しい超高圧下の状態については第一原理計算からの理論予測が期待されるが、現在広く 用いられている計算手法である LDA(局所密度近似)はバンドギャップを過小評価するという欠点のためにギャップの閉 じる圧力について信頼のできる値を求めることができない。そこで我々は今回、我々のグループで現在開発中の新しい第 一原理手法であるトランスコリレイティッド法(Transcorrelated 法)[1]を分子状固体水素に適用し、バンドギャップの 圧力依存性を計算した。トランスコリレイティッド法はもともと量子化学の分野で提唱された波動関数ベースの手法であ り[2]、その要点はJastrow-Slater型波動関数を用いて多体ハミルトニアンの相似変換を行うことで電子相関を含んだ有 効ハミルトニアンに基づいた計算を行うというものである。相似変換されたハミルトニアンは電子間のクーロンポテンシ ャルの遮蔽効果や近距離の相関をすでに含んでいるため、単一のSlater行列式のみを用いた計算でも結果はHartree-Fock 法に比較して劇的に改善される。今回はさまざまな計算手法をつかってバンドギャップの圧力依存性が議論されている mhcp 構造の分子状固体水素の計算を行ったところ、エネルギーギャップは電子密度の減少ともに線形に減少し、金属へ の転移密度は 0.4 mol/cmと予想された。これは半導体のバンドギャップを計算する標準的な手法である GW 近似 [3]や Exact Exchange (EXX)法 [4]の計算結果と良い一致を示している。

[1]. N. Umezawa and S. Tsuneyuki, Int. J. Quantum Chem. 91, 184 (2003), J. Chem. Phys. 119, 10015 (2003).

[2]. S.F. Boys and N.C. Handy, Proc. R. Soc. A309(1969).

[3]. H. Chacham and S. G. Louie, Phys. Rev. Lett. 66, 64 (1991).

[4]. M. Städele and R. M. Martin, Phys. Rev. Lett. 84, 6070 (2000).

P19

Y単結晶薄膜の水素化における結晶成長温度依存性

Growth temperature dependence of hydrogenation of single-crystal yttrium thin films

鈴木 涼¹、ビルデ マーカス¹、松本 益明¹、福谷 克之¹ 1東大生研

イットリウム水素化物 (YHx)は、水素吸収量に応じて格子を hcp(x < 0.4, α 相)から fcc(x = 2, β 相)へと変形させ、電気光学特性を可逆的に変化させることが知られている。これまでに我々は W(110) 基板上に作製した Y(0001 図: 水分子の(a) 単分子過程による解離吸着と(b)2 分子過程による解離吸着。後者のエネルギー障壁は前者のそれに比べて著しく低下する。

単結晶薄膜を水素曝露し、0<x<2の水素吸収量範囲でのY薄膜の水素化過程を共鳴核反応法で研究してきた。膜厚20nmのY単結晶薄膜を1x10⁻³ Paの水素雰囲気中に曝露して水素化させた場合、水素曝露量あたりの水素吸収量変化で定義される水素吸収速度が、水素曝露時の薄膜温度に依存することが確認された。

今発表では、Y単結晶薄膜の水素吸収速度の結晶成長温度依存性について研究した結果を報告する。異なる基板温度で成長させたY単結 晶薄膜を300Kに加熱して5x10⁻⁴Paの水素雰囲気中に曝露した際の 水素吸収量変化をFig.1に示す。結晶成長時の基板温度が増加するに 従って水素吸収速度が低下する様子が見られる。

固体内部に吸収された水素は、結晶粒内か結晶粒界を経路として拡 散する。Y内部での水素の拡散は、水素吸収量が低い領域においては 水素単体の拡散現象として扱うことができるが、水素吸収量の大きい 領域においては格子の変形を伴う。そのため、結晶粒内の水素拡散の エネルギー障壁は結晶粒界を拡散する場合に比べて大きくなることが 見込まれる。これまでの原子間力顕微鏡を用いた研究で、Y単結晶薄 膜成長時の基板温度が上昇することで結晶粒径が増加する結果が報告 されている。本研究の結果から、水素吸収速度の成長温度依存性が、 結晶粒径の変化に起因することが示された。吸収水素深さ分布の測定 結果と併せて、Y単結晶薄膜の水素化モデルについて議論する。



Fig.1: 成長温度が異なる厚さ 20 nm の Y(0001)薄 膜を 300 K に保って水素曝露した際の深さ 7 nm の地点での水素吸収量変化

電気抵抗率で見た高濃度パラジウム-水素系の低温異常

Low Temperature Anomaly of Palladium-Hydrogen System

荒木 秀明¹、坂牧 由梨¹、原田 修治²、久保田 実³
 ¹長岡高専、²新潟大工、³東大物性研

パラジウム-水素系(PdHx)の比熱や電気抵抗率は、過去にその超伝導転移に関連して水素濃度 $0.7 < x \le 1$ の試料に対して 1.5Kから 10Kの測定が報告されているほか、50Kanomaly と呼ばれる 55K付近の比熱・抵抗率異常ピークに関連して水素濃度 $0 \le x \le 0.75$ の試料に対して 40Kから 200Kの限られた水素濃度、温度範囲で報告されてきた[1]。

パラジウム・水素系は低温下においても金属中での水素の拡散が存在し、その機構は量子トンネル効果によることが知ら れている[2]。我々はこのような状態にあるパラジウム中の水素に着目し、低温下の高密度に吸蔵された水素の波動関数の オーバーラップによる新たな量子現象の探索や内部エネルギーの変化を得るために低温度領域からの広範囲な温度領域に わたる比熱の測定を行ってきた。その結果、二相領域である x≤0.6572の試料では 55K 付近にピークを持ち、x>0.6572 の試料では、そのピークは水素濃度の増加に伴いピーク温度が 55K から 85K へと高温側 ヘシフトすることを報告した[3,4]。 より高い水素濃度に対して、この異常ピーク温度がどのように変化するのか興味深い。しかし、比熱測定では 0.5K から 120K までが測定範囲となっており、120K 以上での水素に関する情報が得られていないことや試料の取り付け時の水素濃 度保持が課題となっていた。そこで本研究では、高水素濃度試料での低温異常を高温度領域まで調べることを目的として 抵抗率測定を行った。抵抗率測定においても高水素濃度試料では異常ピーク温度が水素濃度に依存して高温度側 ヘシフト することが予想される。また、抵抗率測定では、測定セルへの試料の取り付けが容易なため、より高水素濃度試料に対す る測定が可能である。

PdHx 試料は、 ϕ 0.50mm の Pd 線(99.95%)を 0.1N-H₂SO₄ 中で電気化学的方法により水素吸蔵を行い、水素吸蔵前後の 質量の差から水素濃度を見積もった。比熱から得られている異常ピーク温度の水素濃度依存性と比較することで、パラジ ウム-水素系の低温異常の起源について議論したい。

[1] Eds. G. Alefeld and J. Völkl, Hydrogen in Metals II, Springer-Verlag, (1978)

[2] Y. Fukai, The Metal-Hydrogen System, Springer, (2005)

[3] H. Araki, S. Harada and M. Kubota, J. Phys. Chem. Solids, 66 (2005) 1490.

[4] H. Araki et al., J. Low Temp. Phys., 134 (2004) 1145.

P21

Cr₂O₃のオルソ・パラ転換と 磁場効果解明に向けたレーザー共鳴誘起蛍光法の開発

Ortho-Para Conversion on Cr₂O₃ Surfaces and Development of Laser-Induced Fluorescence of H₂:for the Analysis of Magnetic-Field Effects on Ortho-Para Conversion

藤原 理悟、二木 かおり、河内 泰三、福谷 克之、岡野 達雄 東京大学生産技術研究所

水素分子は、合成核スピンが1のオルソ水素と0のパラ水素に分類され、波動関数の対称性からオルソ水素は回転量子数Jが奇数、パラ水素は偶数をもつ。水素分子が気体として存在する場合、オルソ-パラ間の転換確率はきわめて低い。しかし水素分子が表面に物理吸着した場合には、表面との相互作用により、オルソ-パラ転換が生じることがわかっている。さらに、磁性体表面では磁場を印加することで、水素分子のオルソ-パラ転換率を操作できることが予測されている[1]。これまで我々は、共鳴イオン化法を用いて、表面でのオルソ-パラ転換の研究を行ってきた。そこで磁場効果が期待される Cr2O3表面での自然転換時間を測定し、273±40sと見積もった。しかし磁場効果の実験を行うためには、荷電粒子を測定 する共鳴イオン化法は適さない。そこで磁場効果観測に向けて、レーザー共鳴誘起による水素分子の蛍光測定法の開発を 行った。

水素分子は、基底状態(X¹∑⁺g)から~12eV上に励起状態(E,F¹∑⁺g)をもつ。励起エネルギーが回転量子数ごとに異なるため、共鳴励起を利用してオルソ水素とパラ水素を弁別することができる。共鳴イオン化法では、E,F 状態へ励起された分子を一光子吸収によりイオン化することで検出する。一方、水素分子は E,F 状態より~1eV 下に B¹∑⁺u 状態をもつ。このため E,F 状態の分子は、一光子発光により B 状態へ緩和することが期待される。今回開発した方法ではこの発光を検出する。 E,F 状態への励起は、~201nmの波長を用いて二光子吸収共鳴過程により実現し、このとき検出される蛍光は~1116nm と考えられる。

P20

実験の詳細は次の通りである。合成石英セル(サイズ: $27 \times 27 \times 70$ mm)に高純度水素ガスを注入し、セル中央に励起レーザーを集光した際に発光する蛍光を測定する。生じる蛍光は、波長 720nm 以下吸収のシャープカットフィルタを介して Si-APD で検出した。セル内の水素圧力は 3×10^4 Pa とし、励起レーザーパルス 10Hz, ~201nm を用いた。Si-APD の逆バイアスは 359.5V とした。蛍光強度を励起光の波長に対してプロットした結果を図1に示す。二光子励起過程を考慮し、蛍光強度はシグナルを励起光強度の2乗で割った値で示した。J=0~3の共鳴波長に相当する値で、発光強度の極大が見られ、期待された $B^1\Sigma^+_u \leftarrow E, F^1\Sigma^+_g$ の発光が観測されたと考えられる。それぞれのピークをガウス関数にあてはめ、得られたピーク値よりボルツマンプロットを行うと、回転温度は 383K と見積もられる。

[1]S. Paris and E. Ilisca, J. Phys. Chem. A <u>103</u>(1999)4964.



図 1.水素分子のレーザー誘起蛍光スペクトル

P22

磁性不純物を含む Ag 表面でのオルソ・パラ転換機構の解明と 純オルソ水素生成装置の作成

Mechanism of ortho-para conversion on Fe-deposited Ag surfaces and clarification of o-p conversion mechanism

二木 かおり、藤原 理悟、松本 益明、福谷 克之、岡野 達雄 東大生研

固体表面上に物理吸着した水素のオルソーパラ転換は、核スピンと基盤電子系や局在スピンとの相互作用を解明するモデルとして注目されている。これまでわれわれの研究室では、光励起脱離と多光子共鳴イオン化法を組み合わせることで 貴金属表面、磁性不純物の存在する表面上での精度ある実験を可能にし、転換機構を明らかにした[1]。

今回磁性不純物の o-p 転換への影響を調べた。Cu 基板上に 30nm のAg を蒸着後 8K で試料表面に 30L 水素を曝露し、 光誘起脱離水素分子を多光子共鳴イオン化法により回転量子数別に弁別測定し、オルソ・パラ率の時間変化を調べた。表 面は、いずれも超高真空下 8K で Ag と Fe を蒸着し作成した。①Fe を蒸着(0.3nm)、②①の上に Ag(30nm)を蒸着し、 それぞれの表面でのオルソ・パラ転換時間 τ の測定を行った。その結果 Fe(0.3nm)/Ag では τ =150s、Ag/Fe(0.3nm)/Ag では τ =12s となった。Fe(0.3nm)/Ag 表面で Ag 表面より転換が加速されること、Ag/Fe(0.3nm)/Ag 表面で転換が最も 早くなることがわかった

一方、オルソ・パラ分離は表面への水素分子の吸着エネルギー差を利用する吸着分離法によっておこなうことができる[2]。 吸着媒である活性アルミナを分離最適温度 20K に冷却し、平衡状態下で水素分子を吸着させる。その際に吸着エネルギー の大きなオルソ水素が選択的に吸着するため分離が可能となる。装置は冷却タンク、活性アルミナを満たした分離セル、 多光子共鳴イオン化法を用いる測定部からなる。今回作成した装置では室温の水素を活性アルミナに吸着する際の急激な 度上昇を防ぐために冷却用水素タンクを作成し、温度上昇を 1K 以下に抑えた。実験は以下の手順で行った。10torr の水 素を 118K に冷却した冷却タンクを通過させ一時冷却し、20K の分離セルに導入する。活性アルミナを 70K に昇温度し脱 離した水素をチャンバーに集積し回転量子数別に水素分子の強度を測定する。

脱離分子のオルソ・パラ濃度は測定開始直後 20K で 1:1、12 分後 60K で 2:1 になった。温度の上昇とともにオルソ・パラ比が大きくなったことから吸着エネルギーの違いによる分離が可能であることがわかった。

[1] K. Fukutani et al., Phys. Rev. Lett. 90 (2003) 096103

[2] C. M. Cunningha et al, J. Am. Chem. Soc. 80 (1957) 2382

P23

低速電子回折法の動力学的解析による Ir(111)清浄表面および水素吸着表面構造の研究

Dynamical low-energy electron diffraction analyses of Clean and H-adsorbed Ir(111) surfaces

松本 益明¹、小倉 正平¹、福谷 克之¹、岡野 達雄¹、岡田 美智雄² ¹東大生研、²阪大院理

水素は金属表面で配位数の多いサイトに解離吸着すると考えられており、Ir(111)表面では3配位のホローサイトとなる

はずだが、高分解能電子損失分光法(HREELS)の実験結果から、 水素は低被覆率で非局在化し、高被覆率では1配位オントップサ イトに吸着するという報告がなされている[1]。本研究では低速電 子回折法(LEED)の動力学的解析法を用いて Ir(111)の清浄表面 と 1000 L(1L=1.33x10-4Pa・s) 水素吸着表面についての構造解析 を試みた。

Ir(111)清浄表面及び水素吸着表面の LEED パターンはどちら も1x1であった。従って基本的には緩和のみが起きると仮定して、 第 1-2 層間距離(d12)、第 2-3 層間距離(d23)、第 3-4 層間距離(d34) および水素吸着表面では水素-Ir 原子間距離の垂直成分(dH-Ir)の パラメータを使用し、動力学的な計算結果と実験結果の比較因子 (ペンドリーの R-factor: R_p) が最小となるように最適化を行っ た。清浄表面について最適化した結果を Fig.1 に示す。5本の I-V 曲線の R_pの平均は 0.13 と、かなり良い一致が得られた。その時 のパラメータは d12=0.2207nm であり、表面の層間距離がバルク の値 (0.2217nm) からほとんど変化していない結果が得られた。 水素吸着表面の解析では、電子の散乱断面積が小さいため水素の



Fig.1 最適条件での実験及び計算 I-V 曲線の比較

吸着位置の決定はできなかったが、基板については d12=0.2230nm とわずかに外側へ緩和することが分かった。ただし緩 和は非常に小さく、これは Ni(111) 面や Ir(100) 面が水素の吸着により、再構成して大きくバックリングしていることと は非常に対照的で、Ir(111)表面が水素吸着によりほとんど影響を受けないことを示唆している。 [1] C.J. Hagedorn, M.J. Weiss, W.H. Weinberg, Phys. Rev. B 60 (1999) R14016.

P24

Rh(111)における第一層水分子のエネルギー・キネティクス・微視的状態

The First Layer of Water on Rh(111) : Energy, Kinetics and Microscopic states

紅谷 篤史1、山本 達1.2、向井 孝三1、山下 良之1、吉信 淳1 1東大物性研、2現スタンフォード放射光施設

金属表面と水分子の相互作用は、電気化学・腐食・不均一触媒の観点から重 要であり、現在までに多くの研究がなされてきた。しかし、金属表面に吸着し た第一層目の水分子については、原子レベルでの構造や挙動など数多くの問題 が残されている。本研究では Rh(111)表面に作製した水(D₂O)単分子層につい て、昇温脱離法(TPD)、赤外反射吸収分光法(IRAS)、スポットプロファイル 分析型低速電子回折(SPA-LEED)を用い調べた。

実験は超高真空下(~5×10⁻¹¹Torr)で行った。水単分子層は水分子を Rh(111)清浄面に 20K で蒸着後、~145K でアニールすることで作製した。測 定は全て 20K で行った。

右下図はRh(111)表面に作製した水単分子層のIRAS スペクトルの被覆率依 存性である。被覆率が 0.17 では、2694cm⁻¹に鋭いピークが観測された。この ピークは、ヘキサマーを構成単位とした二次元島内に存在する水分子の孤立水 酸基の伸縮振動と帰属される[1]。また、2195cm⁻¹の幅広いピークは基板側に 水素原子を向けた水分子の OD 伸縮振動であると帰属した。低被覆率において は(√3×√3)R30°の LEED 像が得られたことから基板に整合した水分子層 が形成されていると考えられる。ここで、Rh(111)面の格子定数は六方晶氷の 格子定数より若干大きいため、基盤に整合した構造をとるためには分子間距離 が氷内部に比べ大きくなる必要があり、よりフラットな水分子層であると考え られる。被覆率が増加するにつれ、2694cm⁻¹のピーク強度は減少し 2723cm⁻¹ に新たなピークが現れた。このピークは氷表面の孤立水酸基と同じ振動数であ ることから、被覆率が増加するにつれ氷表面と同じバイレイヤー水分子層にな ったと考えられる。この他、飽和被覆率での孤立水酸基を持つ水分子と基板側 を向いた水分子の比率、TPD の被覆率依存性について議論する。 [1] S. Yamamoto et al., J.Phys.Chem.B, 109(2005)5816



Fig. IRAS spectra of D₂O layer on Rh(111) as a function of coverage

Y 水素化物の金属 半導体転移機構の解明 ~赤外吸収分光装置の開発~

Metal-semiconductor transition of yttrium hydride: Development of infrared absorption spectroscopy

田中 誠二、鈴木 涼、M.Wilde、福谷 克之、岡野 達雄 東大生研

イットリウム水素化物 YHx は水素吸収量に応じて格子を hcp(x<0.2)→fcc(x=2)→hcp(x=3) と変形させ、さらに x=3 で光学ギャップ 2.8eV の透過型半導体へと変化することが知られている。また近年、YH₃に光を照射すると光誘起半導体 -金属転移することが報告されており、注目を集めている。しかしながら、これまでの多くの研究は酸化防止のために表 面に Pd を被覆した多結晶試料で行われているため、Y の格子変形を伴う水素化過程や YH₃における半導体の起源、光誘 起半導体 -金属転移の機構は未だ解明されていない。

我々は、超高真空下で Pd 被覆のないY単結晶超薄膜を作製し、水素化の原子過程と、金属-半導体転移におけるサイ ズ効果に関する研究を行っている。今回新たに、超高真空下でY超薄膜を作製し、その場で一気圧の水素曝露、電気抵抗 測定、赤外吸収分光測定が可能な装置の開発を行った。装置は2つのステージからなり、上段でレーザアブレーション (λ=532nm)による Y の蒸着と RHEED 観察、下段で水素曝露および電気抵抗測定、赤外吸収分光測定ができるように設 計した。基板は透過光測定と電気測定が可能な CaF₂(111)を使用した。ここで CaF₂(111)面とYの面内方向の格子定数は それぞれ 3.86Å、3.64Åであり、比較的格子整合がよく、エピタキシャル成長することが期待できる。レーザアブレーシ ョンをもちいて Y の蒸着を行ったところ、レーザ強度が 100mJ/pulse のときに 0.15Å/s の速度で蒸着できることがわか った。CaF₂(111)基板上に 1nm のYを成長させる前後の RHEED 図形を観測したところ、Y 蒸着によりバックグランド強 度が増大しているが回折点の位置が変わっていないことから、CaF₂(111)基板上にY(0001)がエピタキシャル成長している と考えられる。

物性研究所談話会

日時:2005年10月26日(水) 午後4時~

場所:物性研究所本館6階 講義室

講師:加藤 礼三

(理化学研究所・分子物性化学研究室)

題目:準三角格子を持つ2次元強相関電子系、Pd(dmit)2塩の電子物性

要旨:

金属錯体 Pd(dmit)2は、+1 価の閉殻カチオンを対イオンとして一連のアニオンラジカル塩を形成する。結晶中では、2 次元伝導層とカチオン層が交互に繰り返されている。伝導層内では、2 量体 [Pd(dmit)2]2⁻ が準三角格子を形成している。 また、通常の分子性導体と異なり、HOMO と LUMO の 2 つの分子軌道が、フェルミ準位近傍に存在していることも大き な特徴である。これらの塩は、常圧ではモット絶縁体であり、フラストレートした常磁性を示す。低温では、対カチオン に依存して、反強磁性秩序、電荷秩序相転移、非磁性状態への相転移等の多様な電子相を見せるが、極低温まで三角格子 の磁性を維持するものもある。圧力(静水圧、1 軸性ひずみ)を印可することによって、超伝導を含む多様な物性を示す。 この圧力効果も、カチオンの種類に大きく依存する。このカチオン依存性は、この系の電子状態を強相関パラメータ UIW (U:二量体上での実効的オンサイトクーロン相互作用、W:バンド幅)だけで説明することは不可能で、スピンフラストレー ションも重要な役割を果たしていることを示唆している。このように、対カチオンや圧力に依存して多様な電子物性を示 す Pd(dmit)2塩について概説する。

日時:2005年11月2日(水) 午後4時~

場所:物性研究所本館6階 講義室

講師: Professor Amnon Aharony

(Tel Aviv University, Ben Gurion University and ISSP, University of Tokyo) 題目:What is really measured in the mesoscopic Aharonov-Bohm interferometer? 要旨:

Mesoscopic solid state quantum dots have raised both basic and applied interest. Some of their physical properties are characterised by the quantum amplitude of resonant transmission of electrons through them. The talk presents an elementary review of experiments and theories describing the use of Aharonov-Bohm interferometers for measuring the phase of this (complex number) amplitude. These include "closed" interferometers, with only two terminals connected to the Aharonov-Bohm loop, and "open" interferometers, with more terminals. After explaining the differences between the mesoscopic and the textbook "two-slit" interferometers, the talk will explain how one could extract the desired phase from both "closed" and "open" experiments, both in the Coulomb blockade and in the Kondo regimes.

- 日時:2005年11月21日(月) 午後4時~
- 場所:物性研究所本館6階 講義室
- 講師: Dr. K. L. Ngai

(Naval Research Laboratory, Washington, DC 20375-5320, USA)

題目: Many-body relaxation and diffusion in complex systems: An important unsolved problem in condensed matter physics

要旨:

Complex systems or materials often are made of atomic, ionic, or molecular units that have nontrivial interactions between them. Relaxation and diffusion of these units are of central importance in many research areas including glass transition, polymer viscoelasticity, ionic conductivity relaxation, colloids, metallic glasses, pharmaceuticals, and etc. Interestingly, in many different kinds of these complex materials, the properties of relaxation and diffusion are general or 'universal'. These universal properties likely originate from the many-body interactions between the relaxing units. Unfortunately, at this time there exists no solution of this well defined and important problem in condensed matter physics. Nevertheless I shall show an approach that can solve many problems as well as bring out the universal properties, but it is still short of being a solution of the problem. By drawing the attention of the audience to this unsolved problem, it is hoped that a complete solution will come in the future.

日時:2005年12月1日(木)午後4時~

場所:物性研究所本館6階 講義室

講師:寺崎 一郎

(早稲田大学理工学部応用物理学科)

題目: 有機サイリスタ: 単結晶で起きる非線形・非平衡現象

要旨:

従来の固体物理学では、物質の結晶構造から出発し、微視的ハミルトニアンを構築し、何がしかの意味で平均場近似を 行い、巨視的な物性を説明してきた。そこでは、典型的な還元論が有効であり、統計力学の手法が有効に機能してきた。 しかし、この成功は、系が均一で熱平衡状態にある(または熱平衡状態からほとんど離れていない)ことが前提であった。 逆に言えば、系が不均一であったり、平衡状態から大きく隔たっていれば、ミクロとマクロは直ちには結びつかない。 最近、我々が調べている有機伝導体 0-(BEDT-TTF)₂CsM'(SCN)₄(M'=Zn, Co) は、奇妙な電気特性を示す。それは非オー ミックであり(非線形)、同一試料であっても電流端子の位置を変えると特性が異なり(非局所)、電圧端子の位置によって 特性が異なる(不均一)。このような現象が、欠陥の極めて少ない単結晶試料で、熱力学的相転移を経由しないで観測され る点が興味深い。特に、この系の非線形伝導は、半導体素子のサイリスタと同じ電流一電圧特性を示し、それゆえにイン バータ(直流-交流変換機)として機能する。

この談話会では、マクロな実験結果(電流-電圧特性)とその意義を平易に解説した後、物質の結晶構造や電子状態を 述べ、我々の見出した非線形現象が、電流による電荷秩序の融解という本質的非平衡現象に帰着することを示す。



【研究部門等】

平成17年10月31日付け

(辞職)

氏	名	所	属	職	名		異	動	内	容	
大山	越 志	低温液化室		技術聑	睵員	辞職					

平成17年11月1日付け

(採用)

氏	名	所属	職	名		異	動	内	容
鈴木	孝 史	附属物質設計評価施設	助	手	採用				

平成17年12月1日付け

(採用)

氏	名	所属	職	名	異 動 内 容
吉田	誠	新物質科学研究部門	助	手	採用(神戸大学分子フォトサイエンス研究センター 研究機関研究員から)

物性研だより第45巻目録(第1号~第4号)

第 45 巻第 1 号 2005 年 4 月

物性研に着任して	1
研究室だより	
○榊原研究室・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	••••• 3
物性研究所短期研究会報告	
○SANS, QENS, NSE で拓くサイエンス・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	••••• 13
物性研究所 ISSP ワークショップ報告	
○「 Si(111)-√3×√3-Ag 構造と相転移」・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	••••• 40
物性研究所談話会・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	53
物性研ニュース	
○人事異動・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	55
○東京大学物性研究所の教員公募の通知・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	59
○平成 17 年度前期短期研究会一覧 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	····· 62
○平成 17 年度前期外来研究員一覧 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	••••• 63
○平成 17 年度中性子回折装置共同利用採択課題一覧 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	71
○平成 17 年度前期スーパーコンピュータ共同利用採択課題一覧 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	83
○平成 17 年度後期共同利用の公募について(通知)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	87
○平成 16 年度外部資金の受入について · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	88
○第 50 回物性若手夏の学校・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	89
編集後記	

第 45 巻第 2 号 2005 年 7 月

隕石の話・・・・・・	松田	准一	 1	
中性子散乱より評価したガラス形成物質のフラジリティー ・・・・・・	筑紫	格	 5	
新規Aサイト秩序型ペロブスカイト Mn 酸化物の開発とランダムネス効果・	中島	智彦	 8	
研究室だより				
○上田研究室・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	上田	和夫	 ••••• 14	
物性研究所短期研究会報告				
○ミクロプローブを用い強磁場物性研究の展開-現状と将来- ・・・・・			 21	
物性研究所 ISSP ワークショップ報告				
○ラットリングと超伝導・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・			 44	
物性研究所談話会・・・・・			 54	
物性研ニュース				
○人事異動・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・			 57	
○東京大学物性研究所の教員公募の通知・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・			 58	
編集後記				

第 45 巻第 3 号 2005 年 10 月

超強磁場下での磁化測定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	香取	浩子		 • • • • • •	1
高強度超短レーザーパルスと物質の超高速相互作用に関する研究 ・・・・・	中嶋	隆	• • • • • • •	 	4
レーザー光電子分光事始め・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	辛	埴		 	6
物性研究所 ISSP ワークショップ報告					
○高圧化の中性子散乱・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・				 	11
物性研究所談話会 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				 	25
物性研ニュース					
○人事異動・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・				 	27
○東京大学物性研究所の客員教授(助教授)公募のご案内・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・				 	28
○2006 年度日米協力「中性子散乱」研究計画の公募・・・・・・・・・・・・・・・				 	30
○平成 17 年度後期短期研究会一覧 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				 	31
○平成 17 年度後期外来研究員一覧				 	32
○平成 17 年度後期スーパーコンピュータ共同利用採択課題一覧 ・・・・・・				 	43
○平成 18 年度前期共同利用の公募について ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・				 	45
○平成 17 年度外部資金の受入について ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・				 	46
編集後記					

第 45 巻第 4 号 2006 年 1 月

第一原理分子動力学法による電極表面シミュレーション ・・・・・	森川	良忠	•••••	1
メゾスコピック系の伝導現象の研究・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	中西	毅		4
重い電子系の研究と冷凍機・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	稲田	佳彦		6
外国人客員所員を経験して・・・・・・				9
	Maka	ariy TA	NATAR	
	Rash	id CAN	IEEV	
	Wour	n KAN	G	
研究室だより				
○柴山研究室・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	柴山	充弘		13
物性研究所短期研究会				
○個体における水素の科学・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・				22
物性研究所談話会・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・				52
物性研ニュース				
○人事異動・・・・・				54
○物性研だより第 45 巻目録(第1号~第4号) ・・・・・・・・・・・・・・・				55
編集後記				

編集後記

今年の冬は近年には珍しく寒い日が続いています。我が家には今年で13歳になる 老猫(ケンタ)がいるのですが、普段は外の風に当たるのが大好きなのに、今年はこ たつの中で冬眠するのを決めたようです。さすがに人は冬眠するわけにはいかないの で、毎日車に付いた霜を融かしてせっせと大学に通っています。春になるのが待ち遠 しい今日この頃です。

さて、今月号の内容ですが、最初に 2005 年度後期に客員所員になられた3人の先 生方の研究紹介が掲載されています。森川先生の電極表面の第一原理分子動力学法に よる研究と中西先生のメゾスコピック系の電気伝導の理論研究は計算機を駆使した 研究であるのに対し、稲田先生の研究は非常に実際的な冷凍機の開発研究であり、物 性研究のスタイルの多様さが実感できます。今回初めての試みとして、3名の外国人 客員所員の先生方に物性研滞在記をお書き頂きました。物性研の設備や日本の文化に 対するお褒めの言葉以外に、セミナーや研究者間の交流に対する改善点なども指摘し て頂き、たいへん意義深い内容です。柴山先生には、日本化学会学術賞を受賞された のを機会に、これまでのゲルを中心としたソフトマターの研究を振り返って頂きまし た。固体物理が中心の物性研において、一人ソフトマターの研究を精力的に進められ、 このように栄えある賞を受賞された柴山先生に心から敬意を表したいと思います。短 期研究会報告では、「固体における水素の科学」研究会の報告がされています。水素 をキーワードに多岐分野の研究者が集まり、2日間で延べ参加者 180 名という、非常 に活発な研究会になりました。アブストラクトをお読み頂くと、内容が本当に多岐に 渡っていることがおわかり頂けると思います。

最後になりましたが、今年一年の皆様のご健康とご発展をお祈りいたします。また、 今後とも物性研だよりをよろしくお願いいたします。

山 室 修